

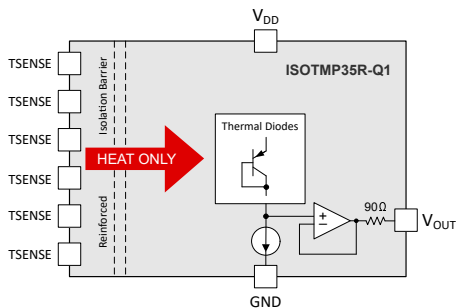
ISOTMP35R-Q1 具有快速响应时间 (< 4s) 和 1.06kV_{RMS} 工作电压的汽车级 ±2.5°C、5kV_{RMS} 增强隔离式模拟温度传感器 (10mV/°C)

1 特性

- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
 - 温度等级-0：-40°C 至 150°C
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 功能安全型
 - 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 稳健的集成隔离：
 - 可承受的隔离电压：5kV_{RMS}
 - 隔离工作电压：1.06kV_{RMS}
 - 隔离栅寿命：> 15 年
 - 提供基础型隔离选项
- 温度传感器精度：
 - ±0.5°C (25°C 时的典型值)
 - 0°C 至 70°C 范围内为 ±2.5°C (最大值)
 - 40°C 至 150°C 范围内为 ±3.5°C (最大值)
- 宽电源电压范围：3.1V 至 34V
- 模拟输出：
 - 10mV/°C 正斜率
 - 0°C 下的偏移电压为 500mV
 - 输出电压范围：100mV 至 2.0V
- 快速热响应：< 4s
- 高 CMTI：65kV/μs
- 低功耗：45μA (典型值)
- 安全相关认证：
 - 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kV_{RMS} 隔离

2 应用

- 混合动力汽车/电动汽车电池管理系统 (BMS)
- HEV/EV 车载无线充电器
- HEV/EV 直流/直流转换器
- HEV/EV 逆变器和电机控制
- 动力总成温度传感器



功能方框图

3 说明

ISOTMP35R-Q1 是业界首款增强型隔离式温度传感器 IC，集成了隔离栅，可承受高达 5kV_{RMS} 电压，具有一个模拟温度传感器，可在 -40°C 至 150°C 范围内实现 10mV/°C 的斜率。通过这种集成，可将传感器与高压热源（例如，功率 MOSFET、IGBT 和汇流条）共位放置，从而无需使用外部隔离放大器或隔离式数据转换器。与通过将传感器放置在较远位置来满足隔离要求的方法相比，直接接触高压热源还可提供更高的精度和更快的热响应。

ISOTMP35R-Q1 在 3.1V 至 34V 的宽电源电压范围内运行，能够在高压域上没有稳压低压轨的系统中实现灵活集成。

对于 -40°C 至 150°C 的温度范围，ISOTMP35R-Q1 的输出电压范围为 100mV 至 2.0V。ISOTMP35R-Q1 不需要进行任何外部校准或修整，即可在室温下提供 ±0.5°C 的最坏情况下的精度，并可在 -40°C 到 150°C 的全温度范围提供 ±3.5°C 精度。ISOTMP35R-Q1 的线性输出、500mV 失调电压和工厂校准简化了在需要读取负温度的单电源环境中的电路要求。

集成隔离栅满足 UL 1577 的要求。表面贴装封装（12 引脚 SSOP）可提供从热源到嵌入式热传感器的出色热流，更大幅度地降低热质量并提供更精确的热源测量。这降低了对耗时热建模的需求，并通过减少由于制造和组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
ISOTMP35R-Q1	DFP (SSOP, 12)	10.3mm × 3.6mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 11。

(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



内容

1 特性	1	7.2 功能方框图.....	14
2 应用	1	7.3 功能说明.....	14
3 说明	1	7.4 器件功能模式.....	21
4 器件比较	3	8 应用和实施	22
5 引脚配置和功能	5	8.1 应用信息.....	22
6 规格	6	8.2 布局.....	28
6.1 绝对最大额定值.....	6	9 器件和文档支持	29
6.2 ESD 等级.....	6	9.1 文档支持.....	29
6.3 建议运行条件.....	6	9.2 接收文档更新通知.....	29
6.4 热性能信息.....	6	9.3 支持资源.....	29
6.5 绝缘规格.....	7	9.4 商标.....	29
6.6 功率等级.....	8	9.5 静电放电警告.....	29
6.7 安全相关认证.....	8	9.6 术语表.....	30
6.8 安全限值.....	8	10 修订历史记录	30
6.9 电气特性.....	9	11 机械、封装和可订购信息	31
6.10 典型特性.....	10	11.1 机械数据.....	32
7 详细说明	14	11.2 封装选项附录.....	35
7.1 概述.....	14	11.3 卷带包装信息.....	36

4 器件比较

表 4-1. 器件选项

特性/参数	ISOTMP35R-Q1	ISOTMP35-Q1
传感器增益	10mV/°C	10mV/°C
传感器增益类型	固定	固定
工作温度范围	-40°C 至 150°C	-40°C 至 150°C
绝缘规格		
绝缘等级	增强	基础
隔离工作电压 (最大值)	1060V _{RMS}	500V _{RMS}
隔离直流电压 (最大值)	1500VDC	707VDC
可承受的隔离电压	5000V _{RMS}	3000V _{RMS}
外部间隙	≥8mm	≥4mm
外部爬电距离	≥8mm	≥4mm
电源规格		
电源电压范围 (V _{DD})	3.1V 至 34V	2.3V 至 5.5V
I _Q (典型值)	45μA	10μA
模拟输出		
输出电压范围 (V _{OUT})	0.1V 至 2.0V	0.1V 至 2.0V
0°C 时的输出偏移电压	500mV	500mV
输出电流 (最大值)	100μA	500μA
输出阻抗 (Z _{OUT})	1kHz 时的 90Ω	1kHz 时的 110Ω
电容负载驱动器 (最大值) 相位裕度 ≥ 45°	2.2nF	1nF
温度精度		
25°C (典型值)	±0.5°C	±0.5°C
-40°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
-30°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
-25°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
-20°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
-10°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
0°C (最大值)	±2.5°C	±1.5°C
20°C (最大值)	±2.5°C	±1.5°C
25°C (最大值)	±2.5°C	±1.5°C
30°C (最大值)	±2.5°C	±1.5°C
70°C (最大值)	±2.5°C	±1.5°C
80°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
85°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
100°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
125°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
130°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
150°C (最大值)	±3.5°C	±2.5°C
封装尺寸		

表 4-1. 器件选项 (续)

特性/参数	ISOTMP35R-Q1	ISOTMP35-Q1
尺寸 [mm × mm × mm]	SSOP (12 引脚) 10.30 × 3.60 × 2.65	SOIC (7 引脚) 4.90 × 6.00 × 1.75

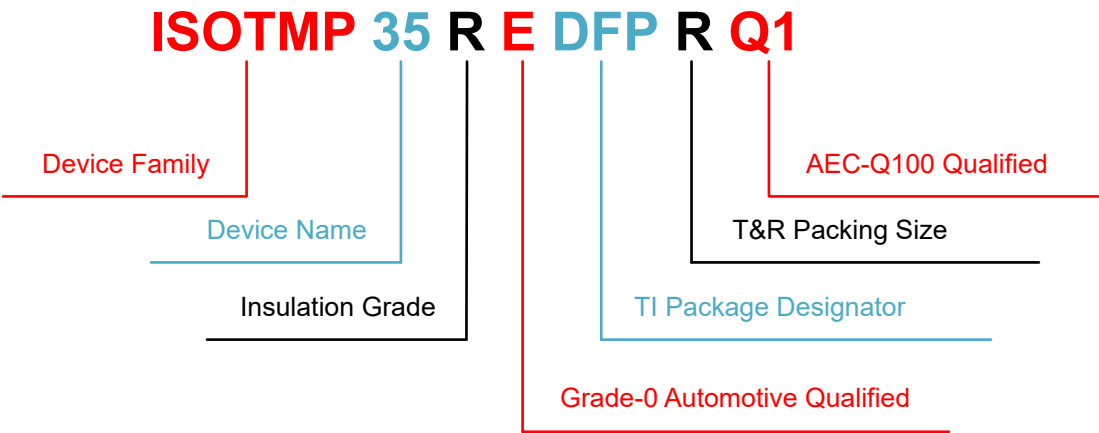


图 4-1. ISOTMP35R-Q1 器件命名规则

表 4-2. ISOTMP35R-Q1 器件命名规则说明

字段说明	字段详细信息
器件系列	• ISOTMP : 隔离式温度传感器
器件名称	• 35
绝缘等级	• R : 增强
汽车级认证	• E : 0 级 (- 40°C 至 150°C) • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
TI 封装标识符	• DFP : 12 引脚 SSOP
T&R 包装尺寸	• R : 大型 T&R、SPQ = 2,000 件

5 引脚配置和功能

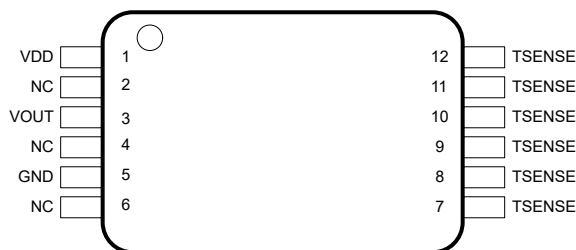


图 5-1. DFP 封装 12 引脚 SSOP 顶视图

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	DFP		
GND	5	G	参考接地。
NC	2	—	无内部连接。这些引脚可保持悬空或连接到 GND。将引脚连接到 GND 可以提升嘈杂环境中的 EMI 稳健性。
	4		
	6		
TSENSE	7	T	隔离式温度检测节点。将 TSENSE 引脚靠近热源放置，以更大限度减少热梯度并提高测量精度。有关布局建议和示例，请参阅节 8.2.1 和节 8.2.2。
	8		
	9		
	10		
	11		
V _{DD}	1	P	电源电压输入。使用低噪声电源，并将 0.1μF 去耦电容器靠近 V _{DD} 和 GND 引脚放置。有关电源建议的其他信息，请参阅节 8.1.4。
V _{OUT}	3	O	模拟输出电压与温度成正比。输出端经过优化，可直接连接到 ADC 输入端。有关电容负载驱动注意事项，请参阅节 7.3.2.2；有关 ADC 接口指南，请参阅节 8.1.3。

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，T = 热检测节点，G = 接地，P = 电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压	V_{DD} 至 GND	GND - 0.3	36	V
输出电压	V_{OUT} 至 to GND	GND - 0.3	$V_{DD} + 0.3$ ⁽²⁾	V
输出电流	I_{OUT}		±10	mA
温度	工作结温 T_J	-60	155	°C
	贮存温度, T_{stg}	-65	155	°C

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 最大电压不得超过 36V。

6.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 ⁽¹⁾ HBM ESD 分类等级 2	±2500	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 CDM ESD 分类等级 C5	±1000	

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 建议运行条件

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{DD}	电源电压	3.1		34	V
T_A	工作环境温度	-40		150	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		ISOTMP35R-Q1	单位
		DFP (SSOP)	
		12 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	99.5	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	127.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	74.1	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	92.6	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	73.4	°C/W
M_T	热质量	110	mJ/°C

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。

6.5 绝缘规格

在自然通风条件下的温度范围内且 $V_{DD} = 3.1V$ 至 $34V$ 时测得 (除非另有说明)

典型值规格条件 : $T_A = 25^{\circ}C$ 且 $V_{DD} = 3.3V$ (除非另有说明)

参数		测试条件	值	单位
通用				
CLR	外部间隙 ⁽¹⁾	端子间的最短空间距离	≥ 8	mm
CPG	外部爬电距离 ⁽¹⁾	端子间的最短封装表面距离	≥ 8	mm
DTI	绝缘穿透距离	最小内部间隙	17	μm
CTI	相对漏电起痕指数	DIN EN 60112 ; IEC 60112	≥ 600	V
	材料组	符合 IEC 60664-1	I	
	过压类别	额定市电电压 $\leq 150V_{RMS}$	I-IV	
		额定市电电压 $\leq 300V_{RMS}$	I-III	
V_{IOWM}	最大交流隔离工作电压	交流电压 (双极性正弦波) : 时间依赖性电介质击穿 (TDDb) 测试	30 年故障率 < 1ppm 15 年故障率 < 1ppm	V_{RMS}
V_{IORM}	最大重复峰值隔离工作电压	峰值电压 (双极性正弦波) : 时间依赖性电介质击穿 (TDDb) 测试	30 年故障率 < 1ppm 15 年故障率 < 1ppm	V_{PK}
V_{IODC}	最大直流隔离工作电压	直流电压 : 时间依赖性电介质击穿 (TDDb) 测试	30 年故障率 < 1ppm 15 年故障率 < 1ppm	V_{DC}
V_{IOTM}	最大瞬态隔离电压	$V_{TEST} = V_{IOTM}$, $t = 60s$ (鉴定测试) , $V_{TEST} = 1.2 \times V_{IOTM}$, $t = 1s$ (100% 生产测试)	7000	V_{PK}
V_{IMP}	最大脉冲电压 ⁽²⁾	在空气中进行测试, 符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50 μs 波形 ⁽⁵⁾	8000	V_{PK}
V_{IOSM}	最大浪涌隔离电压 ⁽³⁾	在油中进行测试 (鉴定测试) , 符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50 μs 波形 ⁽⁵⁾	10400	V_{PK}
q_{pd}	视在电荷 ⁽⁴⁾	方法 a, 输入/输出安全测试子组 2 和 3 后, $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.2 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	pC
		方法 a, 环境测试子组 1 后, $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 60s$, $V_{pd(m)} = 1.3 \times V_{IORM}$, $t_m = 10s$	≤ 5	
		方法 b, 预处理 (类型测试) 和常规测试, $V_{pd(ini)} = V_{IOTM}$, $t_{ini} = 1s$, $V_{pd(m)} = 1.5 \times V_{IORM}$, $t_m = 1s$	≤ 5	
C_{IO}	势垒电容, 输入至输出 ⁽⁵⁾	$V_{IO} = 0.1V_{PP}$ (100kHz)	2.2	pF
R_{IO}	绝缘电阻, 输入至输出 ⁽⁵⁾	$V_{IO} = 500V$ ($T_A = 25^{\circ}C$)	$>10^{12}$	Ω
		$V_{IO} = 500V$ ($100^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$)	$>10^{11}$	
		$V_{IO} = 500V$ ($T_A = 150^{\circ}C$)	$>10^9$	
	污染等级		2	
	气候类别		55/125/21	
UL 1577				
V_{ISO}	可承受的隔离电压	$V_{TEST} = V_{ISO}$, $t = 60s$ (鉴定测试) ; $V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}$, $t = 1s$ (100% 生产测试)	5000	V_{RMS}

- (1) 根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙, 从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下, 印刷电路板上的爬电距离和间隙变为相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
- (2) 在空气中进行测试, 以确定封装的浪涌抗扰度。
- (3) 在油中进行测试, 以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
- (4) 视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
- (5) 将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起, 构成一个双端子器件。

6.6 功率等级

$V_{DD} = 34V$ 、 $T_A = 125^{\circ}C$ 、 $T_J = 150^{\circ}C$ ，器件焊接在器件评估板上。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
P_D	最大功耗	$V_{DD} = 34V$ 、 $I_Q = 140\mu A$ ， V_{OUT} 下空载			4.76	mW

6.7 安全相关认证

UL	
UL 1577 组件认证计划	根据 IEC 62368-1 CB 进行了认证
文件编号：E181974-20250328	证书编号：UL-US-2562181-1

6.8 安全限值

安全限值⁽¹⁾旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_S	安全输入、输出或电源电流	$R_{\theta JA} = 99.5^{\circ}C/W$ ， $V_{DD} = 34V$ ， $T_J = 150^{\circ}C$ ， $T_A = 25^{\circ}C$			37	mA
P_S	安全输入、输出或总功率	$R_{\theta JA} = 99.5^{\circ}C/W$ ， $T_J = 150^{\circ}C$ ， $T_A = 25^{\circ}C$			1.26	W
T_S	最高安全温度				150	$^{\circ}C$

- (1) 最高安全温度 T_S 与器件指定的最大结温 T_J 的值相同。 I_S 和 P_S 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出 I_S 和 P_S 的最大限值。这些限值随环境温度 T_A 而变化。

[热性能信息](#)表中的结至空气热阻 $R_{\theta JA}$ 是安装在器件评估板上的器件的热阻。可使用以下公式计算各参数值：

$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P$ ，其中 P 为器件所耗功率。

$T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{\theta JA} \times P_S$ ，其中 $T_{J(max)}$ 为允许的最大结温。

$P_S = I_S \times V_{DD_{max}}$ ，其中 $V_{DD_{max}}$ 为最大电源电压。

6.9 电气特性

在自然通风条件下的温度范围内且 $V_{DD} = 3.1V$ 至 $34V$ 时测得 (除非另有说明)

典型值规格条件 : $T_A = 25^{\circ}C$ 且 $V_{DD} = 3.3V$ (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
温度传感器							
T _{ERR}	温度精度	T _A = 25°C		±0.5		°C	
		T _A = 0°C 至 70°C		-2.5	2.5		
		T _A = -40°C 至 150°C		-3.5	3.5		
T _{LTD}	长期稳定性和漂移 ⁽¹⁾	1,000 小时, T _A = 150°C		±0.25		°C	
T _{GAIN}	传感器灵敏度 (增益)	T _A = -40°C 至 150°C		10		mV/°C	
V _{OUT}	输出电压	T _A = 0°C		500		mV	
		T _A = 25°C		750			
		T _A = 30°C		800			
T _{NL}	输出非线性	T _A = -40°C 至 150°C		-0.8	0.8		°C
τ _{63_D}	热响应时间 (方向)	2 层 62mil PCB 2oz。铜	T _{63%} T _{STEP} = 25°C 至 75°C	3.7		s	
τ _{63_L}	热响应时间 (搅拌液体)	2 层 62mil PCB 0.5in × 0.5in	T _{63%} T _{STEP} = 25°C 至 150°C	2			
τ _{63_A}	热响应时间 (静止空气)	2 层 62mil PCB 0.5in × 0.5in	T _{63%} T _{STEP} = 25°C 至 75°C	123			
模拟输出							
V _{OUTR}	输出电压范围	T _A = -40°C 至 150°C		100	2000	mV	
Z _{OUT}	输出阻抗	I _{LOAD} = 0 μA 至 100 μA, f = 0Hz 至 1kHz		90		Ω	
I _{OUT}	输出电流	V _{OUT} 拉电流		100		μA	
		V _{OUT} 灌电流		1			
I _{OUT-SC}	输出短路电流限制	V _{OUT} 短路拉电流		0.75	5	mA	
		V _{OUT} 短路灌电流		60	90	μA	
CMTI	共模瞬态抗扰度	V _{DD} = 5V, V _{CM} = 750V, t _{PULSE} = 10 μs C _{LOAD} = 1nF, I _{LOAD} = 50 μA, ΔV _{OUT} < 200mV		65.8		kV/μs	
REG _{LI}	线路调整率	3.1V ≤ V _{DD} ≤ 34V		-1.2	1.2	mV/V	
REG _{LD}	负载调整率	I _{LOAD} = 0 μA 至 100 μA		9		mV	
C _{LOAD}	容性负载驱动	R _{ISO} = 0Ω	相位裕度 ≥ 45°	2.2		nF	
		R _{ISO} ≥ 300Ω		无限			
电源							
I _Q	静态电流	T _A = 25°C、V _{DD} = 3.3V		45	65	μA	
		T _A = -40°C 至 150°C		140			
V _{ON-TH}	导通阈值电压	T _A = -40°C 至 150°C		2.1	2.8	V	
V _{OFF-TH}	关断阈值电压	T _A = -40°C 至 150°C		1.7	2.1	V	
t _{ON}	导通时间	C _{LOAD} = 0pF		25		μs	
PSRR	电源抑制比	T _A = 25°C V _{DD} = 3.3V	f = 1kHz	-75		dB	
			f = 100kHz	-45			
			f = 1MHz	-25			

(1) 在 $150^{\circ}C$ 结温下进行加速使用寿命测试可确定长期稳定性和漂移。

6.10 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

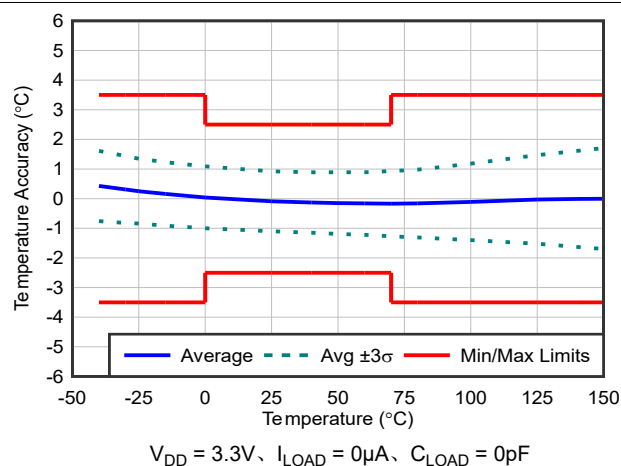


图 6-1. 精度与温度间的关系

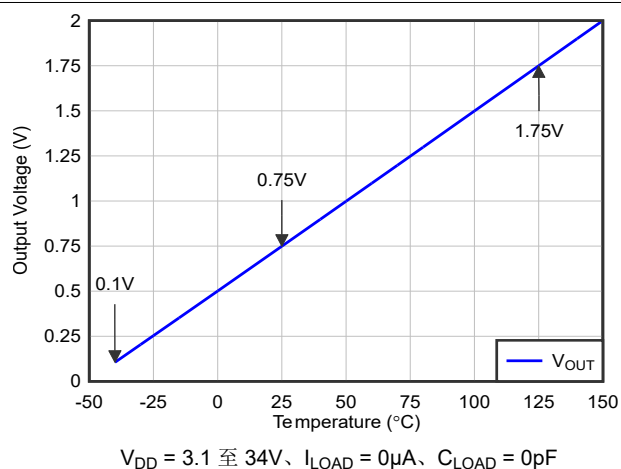


图 6-2. 输出电压与温度间的关系

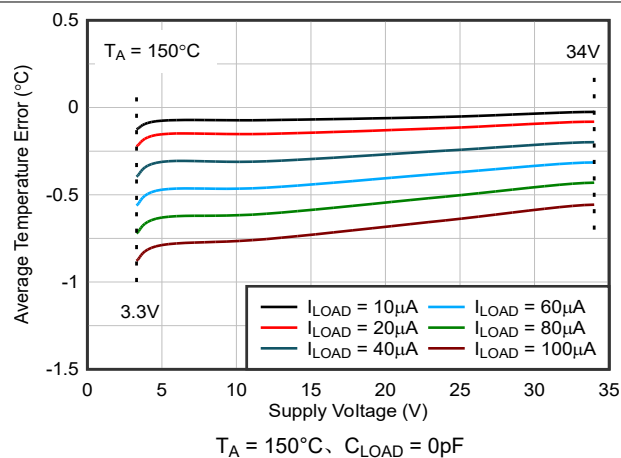


图 6-3. 精度与电源电压和负载电流间的关系

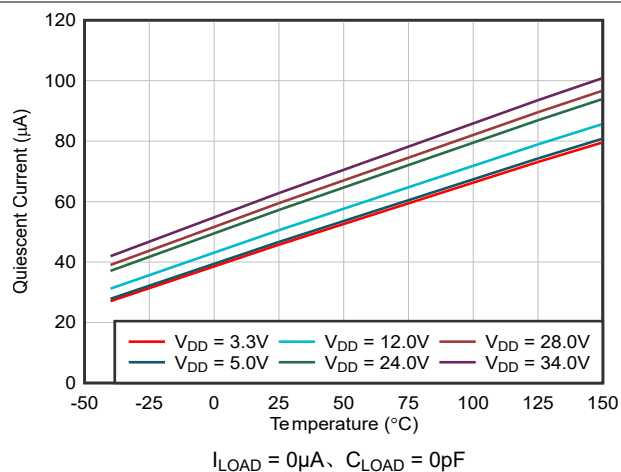


图 6-4. 电源电流与温度间的关系

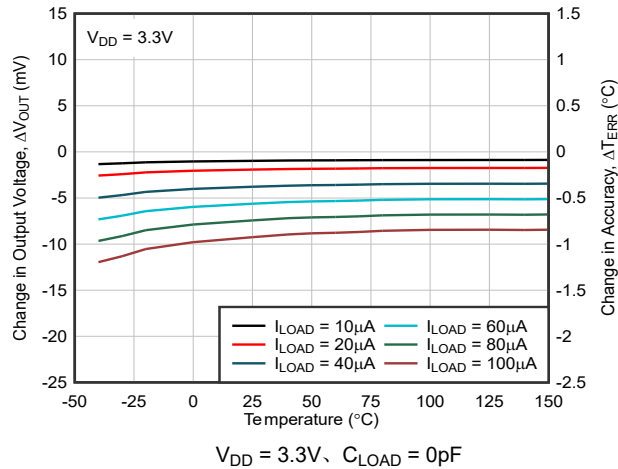


图 6-5. 负载调节与温度之间的关系

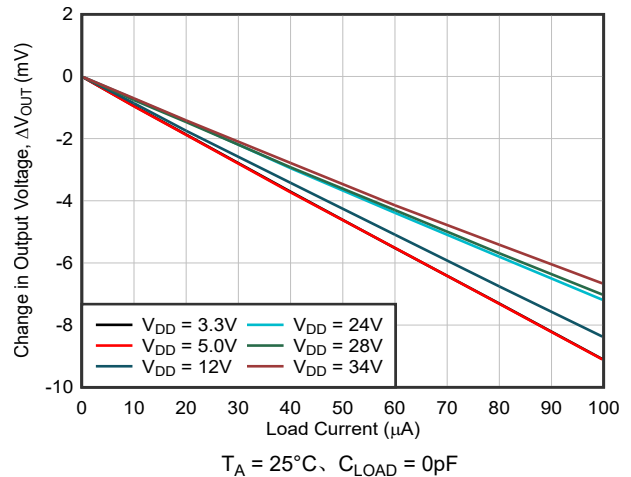


图 6-6. ΔV_{OUT} 与负载电流间的关系

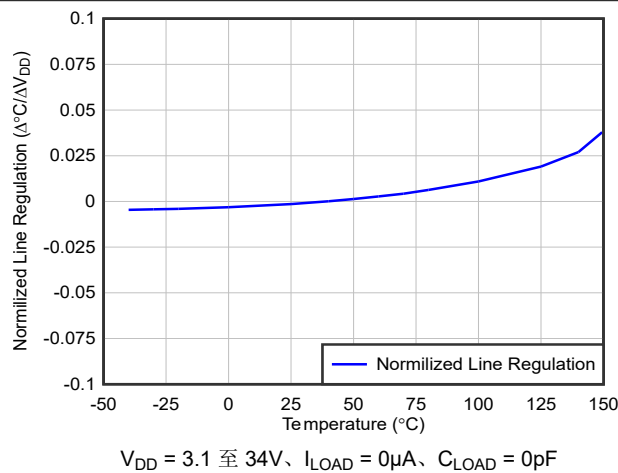


图 6-7. 线路调整率与温度间的关系

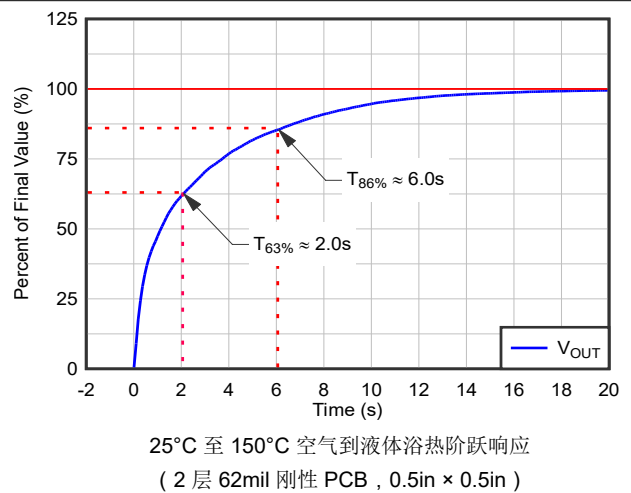


图 6-8. 热响应 (搅拌液体浴)

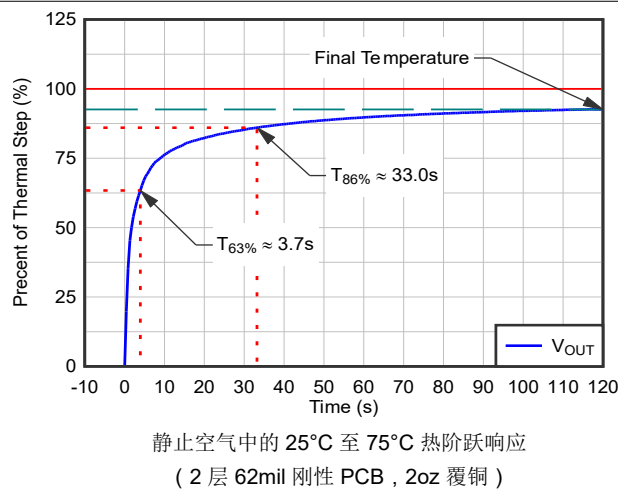


图 6-9. 热响应 (方向)

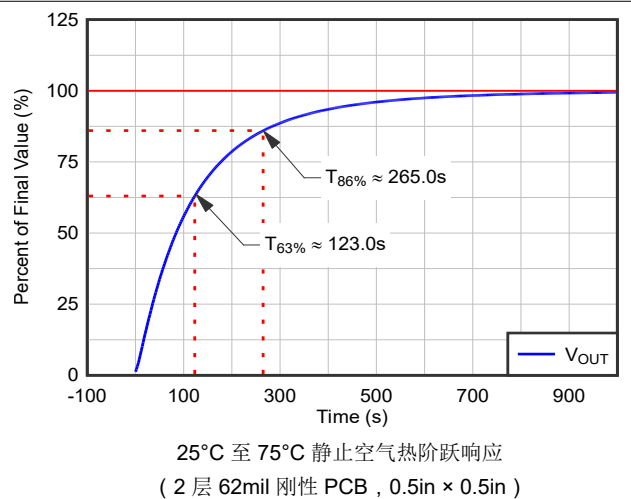


图 6-10. 热响应 (静止空气)

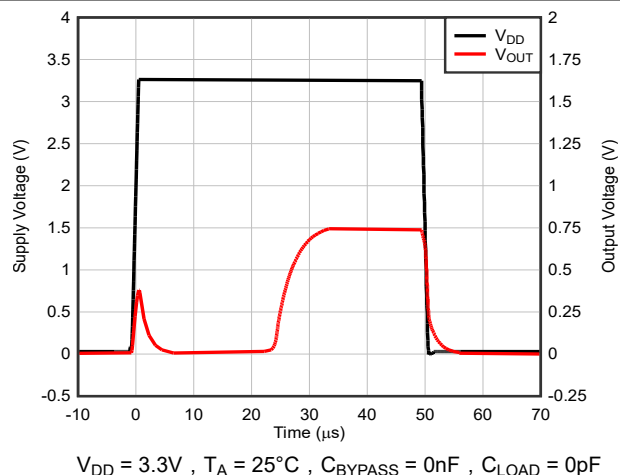


图 6-11. V_{OUT} 对 V_{DD} 的阶跃响应
(转换率 = $2.75V/\mu s$)

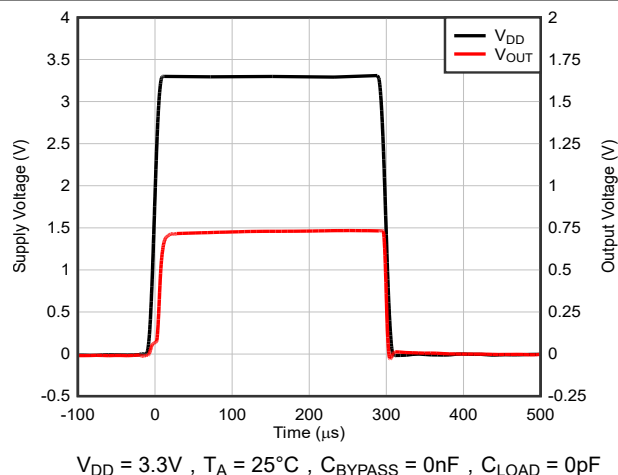


图 6-12. V_{OUT} 对 V_{DD} 的阶跃响应
(转换率 = $0.23V/\mu s$)

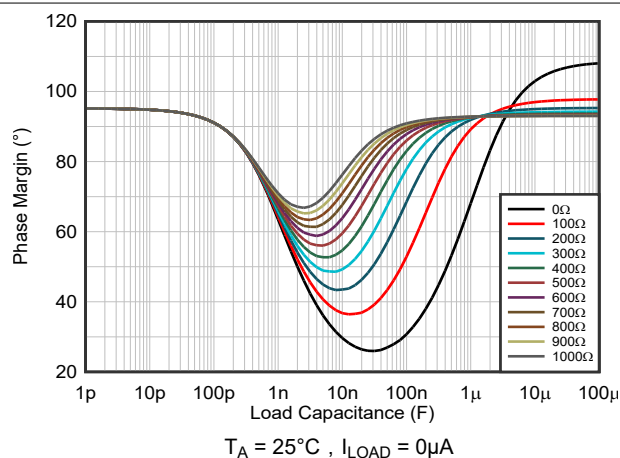


图 6-13. 不同 R_{ISO} 值下相位裕度与电容负载的仿真关系

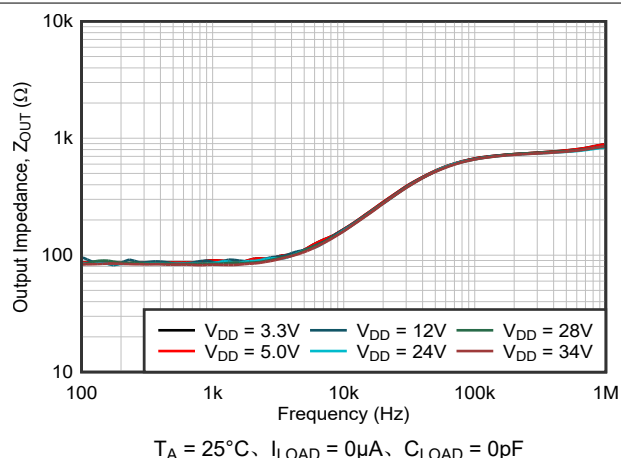


图 6-14. 输出阻抗与频率间的关系

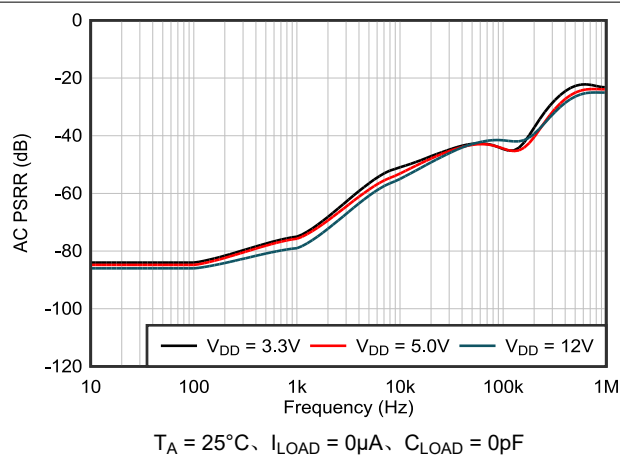


图 6-15. AC PSRR 与频率间的关系

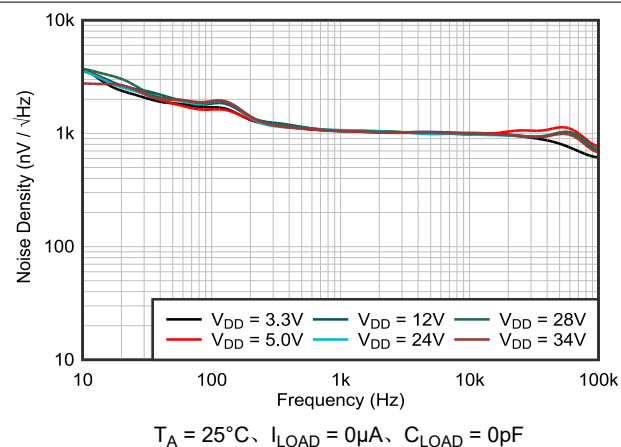


图 6-16. 输出噪声密度

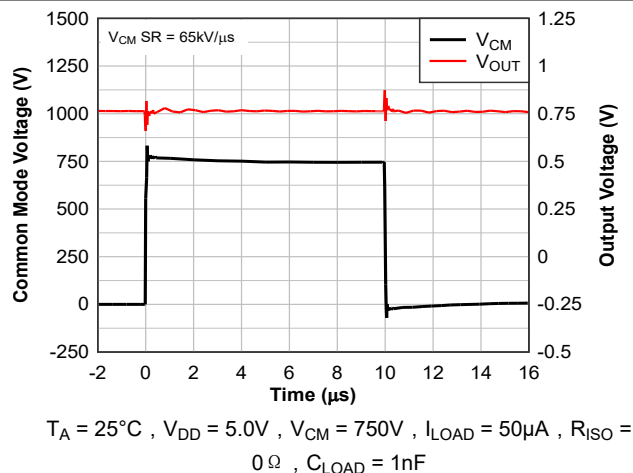


图 6-17. 共模瞬态响应

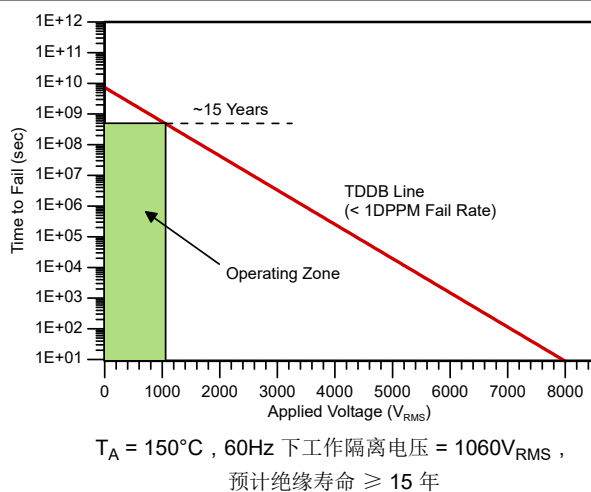


图 6-18. 隔离寿命预测

7 详细说明

7.1 概述

ISOTMP35R-Q1 是一款具有增强型隔离功能的线性模拟输出温度传感器，用于高压节点的精确温度测量。该器件在整个 -40°C 至 150°C 温度范围内提供 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 的正斜率输出，在 0°C 时具有 500mV 的偏移电压。其额定温度精度在 0°C 至 70°C 范围内为 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ ，在完整的 -40°C 至 150°C 温度范围内为 $\pm 3.5^{\circ}\text{C}$ 。

该器件采用 3.1V 至 34V 电源供电，可直接集成至缺乏严格稳压的低压轨的高压平面上。A 类输出驱动器可提供高达 $100\mu\text{A}$ 的拉电流，设计用于直接连接多个 ADC 输入，同时若按照节 7.3.2.2 所述使用 R_{ISO} ，还可支持更高的电容负载。

7.2 功能方框图

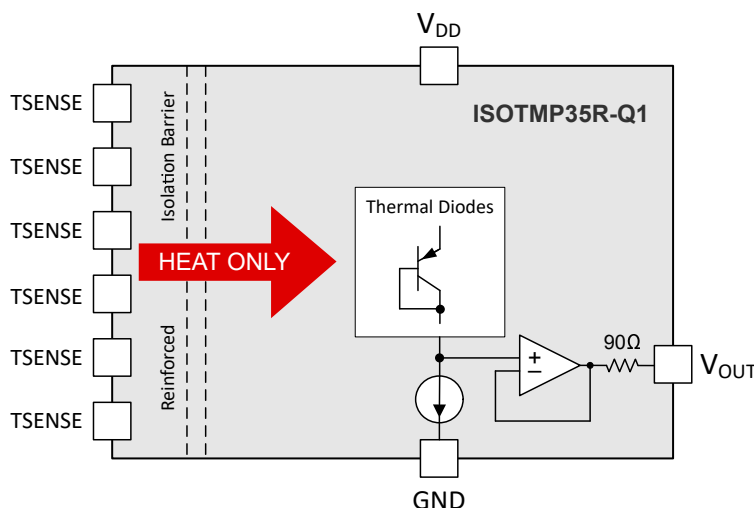


图 7-1. 功能方框图

7.3 功能说明

ISOTMP35R-Q1 集成了一个具有增强型隔离栅和模拟输出级的精密温度检测元件。该器件经过优化，可精确测量高压环境中局部热源的温度。主要功能模块包括温度检测元件、隔离栅及模拟输出驱动器。这些模块协同工作，可直接在热源处进行测量，同时保持与系统控制器之间的电气隔离。

后续章节将详细介绍模拟输出特性、隔离特性及热性能。

7.3.1 集成隔离栅

ISOTMP35R-Q1 内置增强型隔离栅，将高压检测域与低压系统域隔离开来。该隔离栅可确保在检测位置承受高共模电压的应用中进行安全可靠的温度测量。集成隔离栅消除了对外部隔离元件（如隔离放大器或数字隔离器）的需求，降低了系统复杂性并提高了可靠性。

在高压系统中，快速开关跳变（高 dv/dt ）可通过寄生电容耦合并干扰敏感的模拟信号。ISOTMP35R-Q1 的设计可通过内部隔离结构更大限度地减少这种耦合，从而提供高共模瞬态抗扰度（CMTI）。这种高 CMTI 性能使输出在开关事件期间保持稳定。共模瞬态期间的输出响应如图 7-4 所示，器件在经历受控且短暂的扰动后恢复至稳定状态运行。

隔离栅还支持在连续电压应力下保持长期可靠性。隔离寿命采用时间依赖性介电击穿（TDDDB）模型进行表征，确保在预期工作寿命内具有稳健性能。通过将隔离功能直接集成于传感器内部，在原本采用分立方案需更复杂系统设计的环境中，ISOTMP35R-Q1 器件仍能实现精确稳定的温度测量。

7.3.2 输出级和信号特性

ISOTMP35R-Q1 提供与温度成线性比例的低阻抗模拟输出电压。输出级采用直接连接到高压系统中常用的模数转换器 (ADC) 和信号调节网络的设计。

除了提供准确的温度表示之外，输出级还针对电容负载下的稳定运行以及电噪声环境中的稳健性能进行了优化。输出特性受传递函数、负载条件及共模瞬态的影响，具体说明见后续章节。

7.3.2.1 传递函数

ISOTMP35R-Q1 在整个工作范围内提供了与温度呈线性比例的模拟输出电压。这种线性关系允许使用单一比例系数直接将输出电压转换为温度值，从而简化了系统集成。

标称传递函数定义如下：

$$V_{OUT} = (10\text{mV}^{\circ}\text{C} \times T) + 500\text{mV} \quad (1)$$

其中：

- T 为测得的温度，单位为 $^{\circ}\text{C}$

测得的温度可由输出电压通过下式计算得出：

$$T = \frac{V_{OUT} - 500\text{mV}}{10\text{mV}/^{\circ}\text{C}} \quad (2)$$

其中：

- V_{OUT} 为输出电压，单位为 mV

该传递函数在 0°C 时产生 500mV 的输出电压，并在整个温度范围内保持 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 的斜率。例如，在 25°C 时，输出电压约为 750mV ；在 100°C 时，输出电压约为 1.5V 。这种线性关系使得在大多数系统中可以直接将电压转换为温度，无需校准或数字补偿。

[电气特性](#) 中给出的精度限值已包含偏移、增益误差及非线性的综合影响。因此，在大多数应用中可直接使用标称传递函数，无需额外校准或补偿。

对于要求对器件平均响应进行更精确典型拟合的系统，可按 [节 8.1.1](#) 所述采用分段线性逼近法。

7.3.2.2 驱动容性负载

ISOTMP35R-Q1 的输出级能够驱动实际系统中常见的电容负载，包括 ADC 输入、PCB 互连及外部滤波网络。在不额外串联隔离电阻的情况下，该器件支持高达 2.2nF 的电容负载，同时可保持至少 45° 的相位裕度。在该条件下，可以直接连接多个 ADC 输入及短 PCB 走线，无需外部缓冲。

对于电容负载较大的应用，串联隔离电阻器 (R_{ISO}) 可改善环路稳定性。该电阻器将输出级与负载电容隔离开来，并减小负载引入的相移，从而防止振荡或过大的峰值。图 7-2 展示了相位裕度随负载电容和 R_{ISO} 变化的仿真曲线。

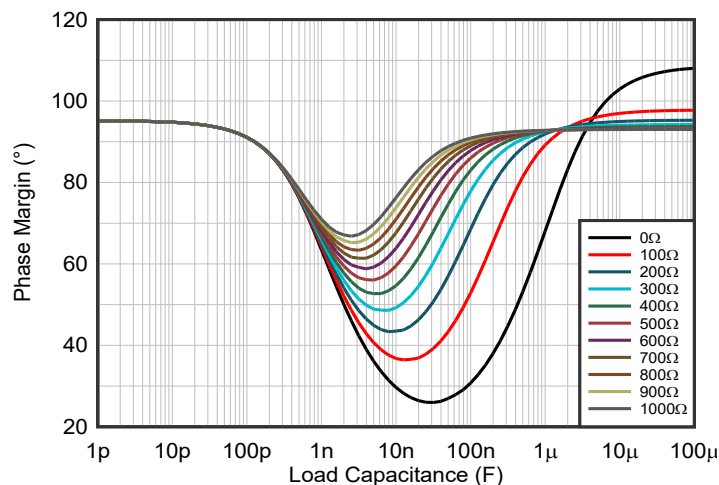


图 7-2. 不同 R_{ISO} 值下相位裕度与电容负载的仿真关系

当 R_{ISO} 大于或等于 300 Ω 时，该器件在整个电容负载范围内可保持大于或等于 45° 的相位裕度，从而能够独立于负载电容稳定运行。此特性简化了系统设计，在包含长 PCB 走线、电缆或大容量输入滤波电容器的应用中无需严格控制负载电容。图 7-3 展示了使用 R_{ISO} 将输出与大电容负载相隔离的典型实现方案。

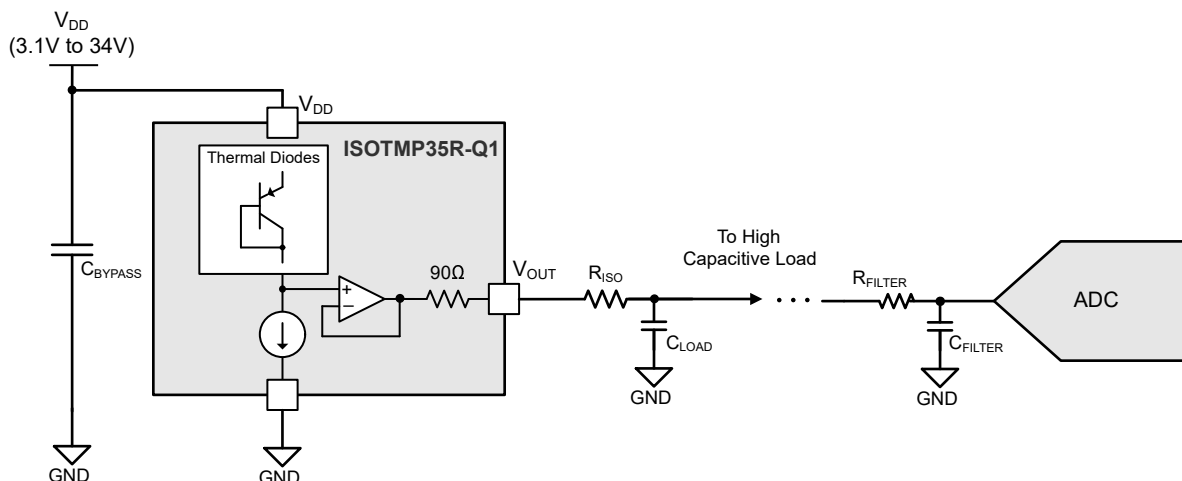


图 7-3. 使用串联隔离电阻器 (R_{ISO}) 驱动电容负载

表 7-1 提供了典型电容负载范围的建议 R_{ISO} 值。这些数值基于图 7-2 所示相位裕度特性得出，为维持稳定运行提供了实用的设计指导。

表 7-1. 稳定运行下的建议 R_{ISO} 值与电容负载对照表

C_{LOAD} 范围	$R_{ISO} = 0\ \Omega$	$R_{ISO} = 100\ \Omega$	$R_{ISO} = 200\ \Omega$	$R_{ISO} \geq 300\ \Omega$
$< 2.2\text{nF}$	$\geq 50^\circ$	$\geq 50^\circ$	$\geq 50^\circ$	$\geq 55^\circ$
$2.2\text{nF} - 47\text{nF}$	$25^\circ - 45^\circ$	$35^\circ - 50^\circ$	$40^\circ - 55^\circ$	$\geq 45^\circ$
$47\text{nF} - 1\mu\text{F}$	$\geq 25^\circ$	$\geq 40^\circ$	$\geq 55^\circ$	$\geq 65^\circ$
$> 1\mu\text{F}$	$\geq 70^\circ$	$\geq 90^\circ$	$\geq 90^\circ$	$\geq 90^\circ$

如表 7-1 所示，相位裕度在中等电容负载区域（约 2nF 至 50nF）呈现最小值，该区域中输出级与负载电容的相互作用引入了额外的相移。随着负载电容进一步增加，输出极点会移至较低的频率，从而降低环路带宽，并导致在累积显著的高阶相位滞后之前发生增益交越。这种行为可改善较高容性负载下的相位裕度，并实现更稳定的主极点响应。使用串联隔离电阻器 R_{ISO} 时，会引入一个零点，帮助补偿负载电容的相位滞后，从而进一步提高整个负载范围内的稳定性。

尽管输出级支持较大的电容负载，但过大的负载会延长趋稳时间并可能引入自热效应，从而降低测量精度。因此，建议尽可能减小输出负载。

7.3.2.3 共模瞬态抗扰度 (CMTI)

共模瞬态抗扰度 (CMTI) 描述了 ISOTMP35R-Q1 在高压检测域与低压系统域之间出现快速电压瞬变时保持输出稳定的能力。在功率转换器、电机驱动器及电池系统等应用中，开关器件会产生快速电压跳变（高 dv/dt ），这些跳变可通过寄生电容耦合，干扰敏感的模拟信号。如果没有足够的 CMTI 性能，这些瞬变可能导致测得的温度输出出现误差或毛刺。

ISOTMP35R-Q1 专为在此类环境中可靠工作而设计，其典型 CMTI 额定值为 $65\text{kV}/\mu\text{s}$ 。该值表示在输出扰动幅度与持续时间保持在规定范围内时，所能承受的最大共模电压变化率。

图 7-4 展示了 ISOTMP35R-Q1 在共模瞬态事件期间测得的输出响应。在此测试中，在隔离栅两端施加高 dv/dt 电压阶跃，同时监测输出。该器件可保持输出完整性，任何瞬态偏差的幅值与持续时间均受到限制（例如，幅值 $< 200\text{mV}$ ，持续时间 $< 4\mu\text{s}$ ），对温度测量的影响极小。这种受控响应证实了即使在存在快速开关事件的情况下，温度测量依然保持准确。

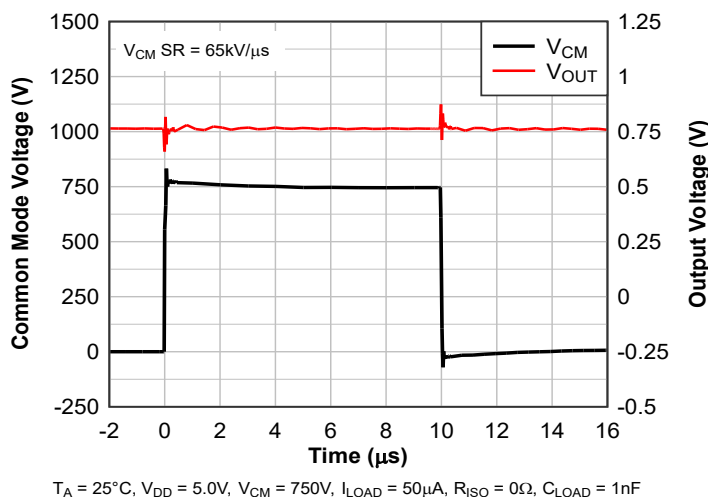


图 7-4. 共模瞬态响应

高 CMTI 性能得益于内部隔离结构以及隔离栅两端的低寄生耦合。此外，系统级滤波与合理的 PCB 布局可进一步降低高频瞬变的影响（有关滤波技术的更多详情，请参阅节 8.1.5.1）。

7.3.3 热响应

SSOP-12 封装旨在最大限度增加热流并最大程度缩短 TSENSE 引脚到温度传感器的热响应时间，同时还提供 5kV_{RMS} 隔离额定电压 (UL 1577)。

ISOTMP35R-Q1 的热响应取决于 TSENSE 引脚与热源之间的热耦合，以及周围环境和 PCB 设计。与测量环境温度或电路板温度的常规温度传感器不同，ISOTMP35R-Q1 采用通过直接热耦合来测量局部热源温度的设计。这一功能通过专用的 TSENSE 引脚实现，这些引脚应靠近发热元件放置。

鉴于热特性在不同应用间具有显著差异，我们在多种测试条件下对 ISOTMP35R-Q1 进行了特性表征，以便全面理解其性能表现。这些条件包括定向加热、搅拌液体环境以及静止空气环境，后续章节将予以讨论。

7.3.3.1 搅拌液体热响应

搅拌液体热响应代表了整个封装内温度均匀耦合的最佳热工况，此时整个器件处于受控且均一的温度环境中。

在此测试中，器件浸入循环液体浴中，使得封装的所有部分同时经历相同的温度。这更大幅度地减少了器件上的热梯度，反映了内部温度传感器的固有响应。

图 7-5 展示了搅拌液体测试配置，图 7-6 展示了 125°C 温度阶跃 (25°C 至 150°C) 下测得的相应热响应。图 7-6 中的红色实线参考线表示最终稳定状态温度 (100%)，而响应曲线则显示了器件趋近该值的瞬态特性。

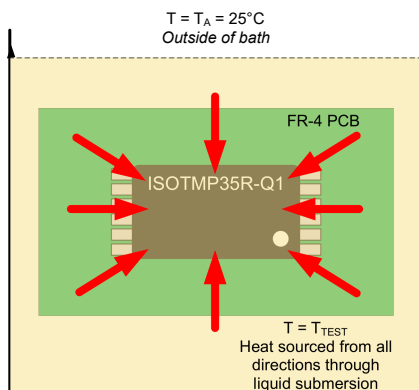


图 7-5. 搅拌液体测试设置

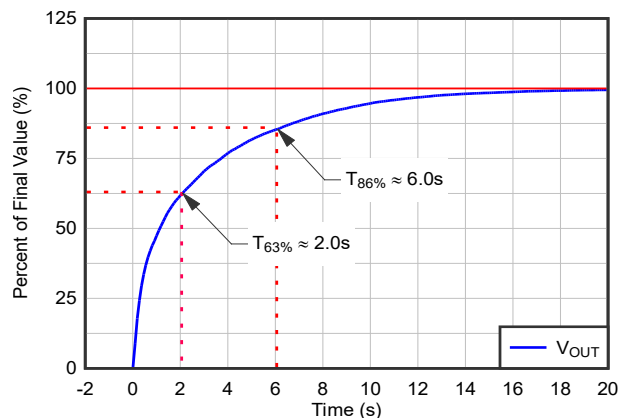


图 7-6. 热响应 (搅拌液体浴)

在此条件下，器件呈现一阶热响应。输出约在 2.0 秒内达到最终值的 63%，约在 6.0 秒内达到 86%，与一阶系统特性一致。

7.3.3.2 定向热响应

定向热响应代表了 ISOTMP35R-Q1 器件最贴合实际应用的热工况。在此测试中，热量主要通过 TSENSE 引脚施加，而其余器件引脚则暴露于环境温度中。此配置反映了真实应用场景：器件与局部高压热源（如功率晶体管或铜平面）热耦合，而封装其余部分受环境条件影响。

图 7-7 展示了定向热力测试配置，图 7-8 展示了 50°C 温度阶跃（25°C 至 75°C）下测得的相应热响应。

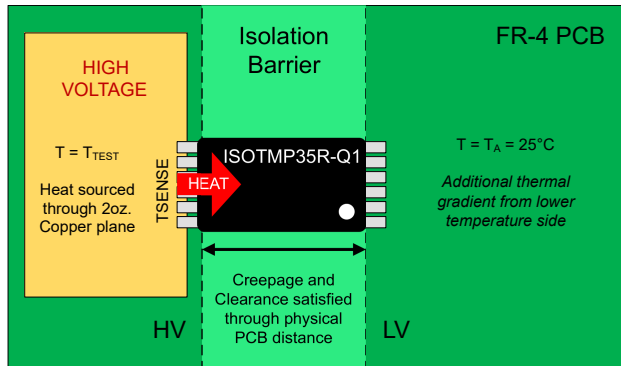


图 7-7. 定向热力测试设置

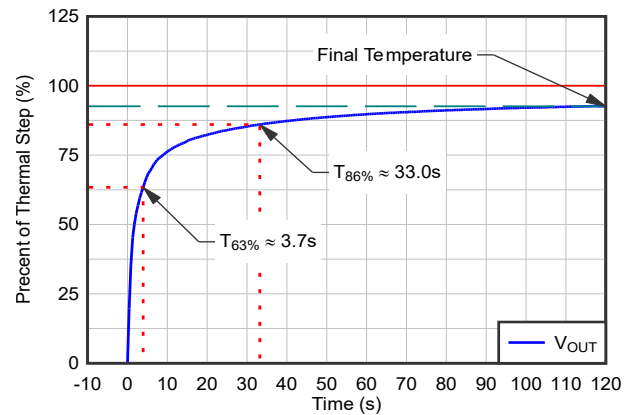


图 7-8. 热响应（方向）

与搅拌液体工况不同，整个封装上存在热梯度。因此，测得的响应趋近于一个低了 100% 的所施加温度阶跃的稳定状态值。这是因为仅封装的一部分通过 TSENSE 引脚受热，其余区域则向周围环境散热。

热响应遵循一阶特性，如 图 7-8 所示，约在 3.7s 内达到最终值的 63%。这表明热量通过 TSENSE 引脚在热源与内部温度传感器之间实现了快速热耦合。

ISOTMP35R-Q1 的封装经过优化，可更大限度提升通过 TSENSE 引脚的热传导效率，从而促进热量从热源向内部温度传感器的高效传递。与需要远距离放置传感器的非隔离方案相比，将 TSENSE 引脚直接置于高压热源处能够实现更快的响应速度与更高的测量精度。

7.3.3.2.1 与 NTC 热敏电阻比较

与 NTC 热敏电阻的比较凸显了 ISOTMP35R-Q1 通过直接热耦合所实现的优势。在此测试中，热量通过与 TSENSE 引脚相连的高压铜平面施加，而低压侧保持在 25°C。在热源处施加 100°C 的温度阶跃 (25°C 至 125°C)。此工况代表了相关温度集中在热源局部位置而非均匀分布于整个封装上的应用。

图 7-9 展示了 ISOTMP35R-Q1 和分立式 NTC 实现方案的测试配置。ISOTMP35R-Q1 通过 TSENSE 引脚直接与热源进行热耦合。相比之下，NTC 热敏电阻则置于约 8mm 距离外，热传递依赖于 PCB 材料，并且在其中一种配置中借助了导热环氧树脂进行热传递。

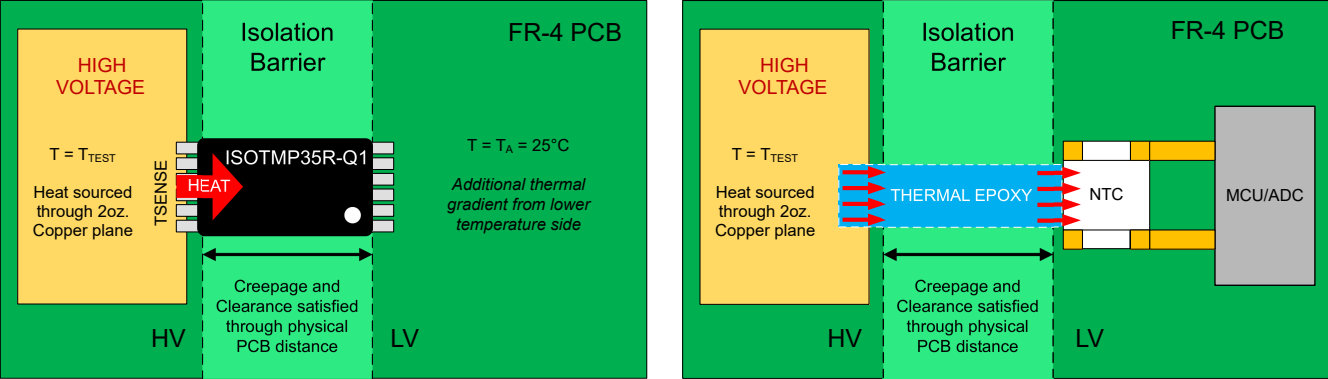


图 7-9. 测试设置：ISOTMP35R-Q1 与 NTC 的比较

图 7-10 展示了 ISOTMP35R-Q1 与两种 NTC 配置 (含与不含导热环氧树脂) 的实测热响应比较情况。

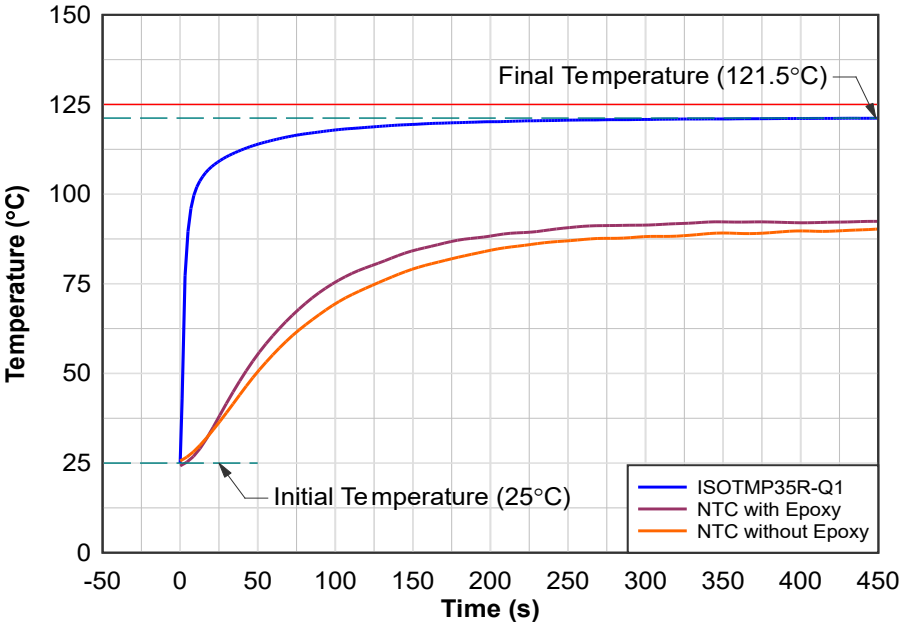


图 7-10. 热响应比较

根据 表 7-2 中的总结，ISOTMP35R-Q1 达到最终温度的速度显著更快，且在瞬态响应期间更接近 125°C 的参考值。这一特性源于通过 TSENSE 引脚实现的直接热耦合，该方式更大限度地降低了热源与检测元件之间的热阻。

表 7-2. 响应时间与最终温度比较

参数	ISOTMP35R-Q1	NTC (含环氧树脂)	NTC (不含环氧树脂)
热耦合路径	直接 (通过 TSENSE 引脚)	间接 (FR-4 PCB 和导热环氧树脂)	间接 (仅 FR-4 PCB 导热路径)

表 7-2. 响应时间与最终温度比较 (续)

参数	ISOTMP35R-Q1	NTC (含环氧树脂)	NTC (不含环氧树脂)
耦合材料热导率	铜缆: 400W/mK	环氧树脂: 3.7W/mK	FR-4: 0.2W/mK
离热源的距离	直接耦合	8mm	8mm
响应时间 ($\tau_{63\%}$)	4.7s	75.0s	90.5s
响应时间 ($\tau_{86\%}$)	24.6s	143.4s	173.6s
最终温度	121.5°C	92.5°C	90.5°C

备注

所示热导率值为热耦合路径中主要材料的整体代表性数值, 仅供相对比较之用。实际热响应取决于包括几何尺寸、界面厚度、接触面积及 PCB 结构在内的完整热路径。

相比之下, NTC 实现方案因与热源存在物理隔离且包含中间材料, 引入了额外的热阻和延迟。与裸露的 NTC 相比, 使用导热环氧树脂改善了导热, 但仍导致响应较慢, 且与参考温度的偏差增大。

有关测试方法、热建模及系统级注意事项的更多详细信息, 请参阅应用手册 [改善高压应用中的热响应时间与精度](#)。

7.3.3.3 静止空气热响应

静止空气热响应代表热传递主要依靠自然对流的最恶劣工况。在此环境中, 热传递速率显著低于定向或液体冷却工况, 导致响应时间变慢。此工况凸显了在 TSENSE 引脚与热源之间进行适当热耦合的重要性。图 7-11 展示了相应的静止空气响应特性。

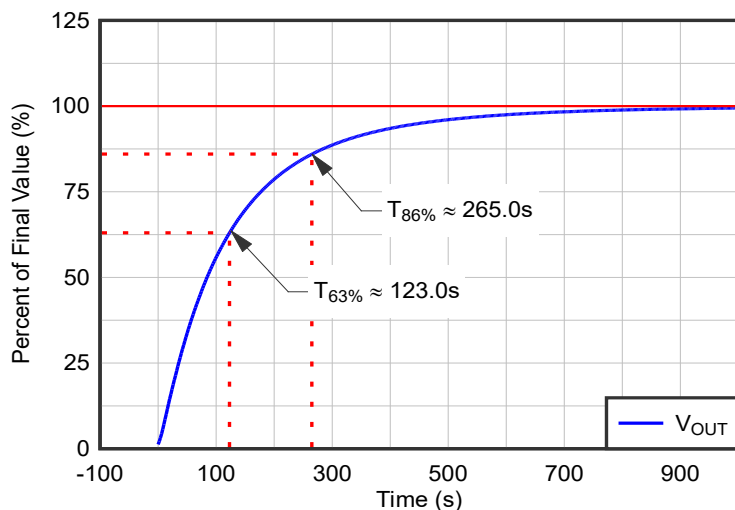


图 7-11. 热响应 (静止空气)

7.4 器件功能模式

ISOTMP35R-Q1 的单一功能模式是与温度成正比的模拟输出。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

ISOTMP35R-Q1 专为高压系统中的温度测量而设计，此类系统要求电气隔离并对局部热源进行精确检测。

该器件在 3.1V 至 34V 的宽电源电压范围内运行，并且具有低电流消耗，同时支持线路供电和电池供电应用。集成隔离栅支持将器件直接放置在高压节点，无需外部隔离元件并简化了系统设计。

模拟输出呈现出线性的温度特征，可直接连接至标准 ADC 输入。合理系统设计的注意事项（包括热耦合、输出负载及滤波）将在后续章节予以阐述。

8.1.1 采用分段线性逼近提高精度

对于要求精度高于标称传递函数的应用，可采用分段线性逼近方法更准确地表示输出电压随温度的变化关系。

尽管 ISOTMP35R-Q1 的输出具有高线性度，但仍可能出现与标称传递函数的微小偏差，尤其是在极限温度下。分段线性方法将温度范围划分为多个区间，每个区间由各自的增益和偏移电压定义，从而降低这种残余非线性。

在使用更高分辨率 ADC、具有低系统噪声且要求无需全面校准即可在全工作温度范围内实现改善的典型精度的系统中，此方法最为有效。

输出电压可由测得的温度通过下式计算得出：

$$V_{OUT} = T_C \times (T - T_{INFL}) + V_{OFFS} \quad (3)$$

反之，测得的温度可由测得的输出电压通过下式计算得出：

$$T = \frac{V_{OUT} - V_{OFFS}}{T_C} + T_{INFL} \quad (4)$$

其中：

- V_{OUT} 为输出电压，单位为 mV
- T 为测得的温度，单位为 °C
- T_{INFL} 为一个分段温度拐点，单位为 °C
- T_C 为温度系数或增益，单位为 mV/°C
- V_{OFFS} 为输出电压偏移，单位为 mV

表 8-1 总结了每个温度分段的分段线性系数。可以根据目标温度范围选择一组适当的系数，以实现更高的精度。

表 8-1. 用于提高精度的分段线性系数

T _{RANGE} (°C)	V _{RANGE} (mV)	T _{INFL} (°C)	T _C (mV/°C)	V _{OFFS} (mV)
-40.0 至 10.0	100 至 600	-40.0	9.91	104
10.0 至 70.0	600 至 1200	10.0	9.98	599
70.0 至 150.0	1200 至 2000	70.0	10.02	1198

表 8-2 提供了代表性的传递值，包括基于 方程式 1 得出的标称值、依据 表 8-1 计算得出的分段线性值，以及基于平均实测数据生成的查找表数值。

标称传递函数为无需更高精度的系统提供了一种简化的实现方案。为提升系统级精度，可根据系统需求选用分段线性值或实测查找表数值。

为清晰起见，表 8-2 中的值进行了四舍五入。基于平均实测数据生成的完整查找表可在 [ISOTMP35R-Q1 产品文件夹](#) 中找到。

备注

对于不需要增强型典型线性校正的应用，可以在整个工作温度范围内使用 方程式 1 所示的标称传递函数。

表 8-2. 传递值 (标称值, 实测值和计算出的分段值)

温度 (°C)	标称 V_{OUT} (mV)	实测 V_{OUT} (平均值) (mV)	计算出的分段 V_{OUT} (mV)
-40.0	100.0	104.3	104.0
-35.0	150.0	153.7	153.6
-30.0	200.0	203.1	203.1
-25.0	250.0	252.5	252.7
-20.0	300.0	302.0	302.2
-15.0	350.0	351.6	351.8
-10.0	400.0	401.2	401.3
-5.0	450.0	450.7	450.9
0.0	500.0	500.4	500.4
5.0	550.0	550.1	550.0
10.0	600.0	599.8	599.0
15.0	650.0	649.6	648.9
20.0	700.0	699.3	698.8
25.0	750.0	749.1	748.7
30.0	800.0	798.9	798.6
35.0	850.0	848.8	848.5
40.0	900.0	898.7	898.4
45.0	950.0	948.6	948.3
50.0	1000.0	998.5	998.2
55.0	1050.0	1048.4	1048.1
60.0	1100.0	1098.4	1098.0
65.0	1150.0	1148.3	1147.9
70.0	1200.0	1198.3	1198.0
75.0	1250.0	1248.3	1248.1
80.0	1300.0	1298.4	1298.2
85.0	1350.0	1348.5	1348.3
90.0	1400.0	1398.6	1398.4
95.0	1450.0	1448.8	1448.5
100.0	1500.0	1498.9	1498.6
105.0	1550.0	1549.1	1548.7
110.0	1600.0	1599.2	1598.8
115.0	1650.0	1649.4	1648.9
120.0	1700.0	1699.6	1699.0
125.0	1750.0	1749.7	1749.1
130.0	1800.0	1799.8	1799.2
135.0	1850.0	1849.9	1849.3
140.0	1900.0	1899.9	1899.4
145.0	1950.0	1950.0	1949.5
150.0	2000.0	2000.0	1999.6

8.1.2 输出缓冲和信号完整性注意事项

在许多应用中，ISOTMP35R-Q1 的输出可直接连接至 ADC 输入端，无需外部缓冲器。输出级具备足够的驱动能力，可应对典型电容负载及短距离 PCB 互连。

如节 7.3.2.2 所述，在不添加额外元件的情况下，输出端在电容负载高达 2.2nF 时仍保持稳定。对于更大的电容负载，使用串联隔离电阻器 (R_{ISO}) 可实现不受负载电容影响的稳定运行。在此类情况下，无需外部缓冲器即可确保稳定性。

在某些系统条件下，外部缓冲器可提升整体信号完整性与稳健性。这些条件通常涉及长 PCB 走线、电缆接口、多路负载或电噪声环境，在这些环境中，信号衰减和耦合可能降低性能。

外部缓冲器可根据系统需求实现为单端或差分形式。对于中等走线长度及低噪声环境，单端缓冲器通常已足够。在要求更高抗噪声能力或更长距离可靠传输的应用中，可采用差分信号传输。

此外，缓冲有助于将传感器输出与下游电路隔离开，从而降低分布式寄生效应的影响，并改善高 EMI 环境下的性能。

图 8-1 展示了一个示例实现方案，其中 ISOTMP35R-Q1 的输出经缓冲后以差分信号形式传输，以在更长距离上提高抗噪声能力。

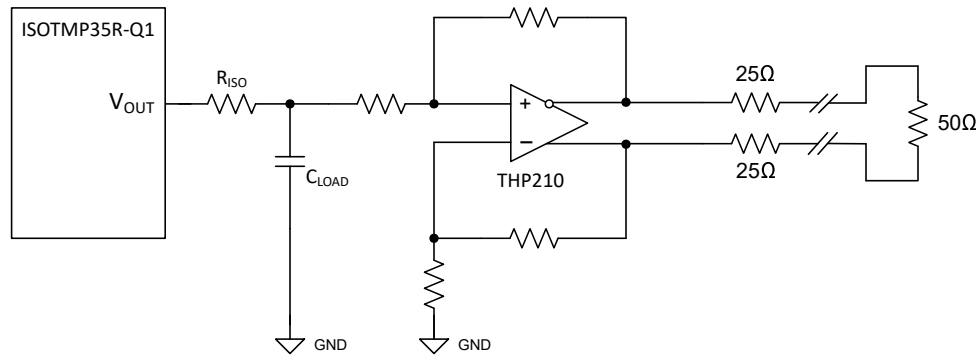


图 8-1. 缓冲差分对数据传输

在走线短、负载单一且噪声耦合有限的应用中，ISOTMP35R-Q1 的输出可直接使用，无需缓冲器。

8.1.3 ADC 接口注意事项

ISOTMP35R-Q1 提供模拟输出电压，该电压直接连接到模数转换器 (ADC)。

为了达到额定温度精度，建议 ADC 分辨率至少为 12 位。例如，采用 2.5V 基准电压时，12 位 ADC 的 LSB 大小约为 0.61mV，对应的温度分辨率约为每 LSB 0.061°C。该分辨率足以满足大多数温度监测应用的要求。

对于需要更高分辨率的系统，可使用更高分辨率的 ADC (例如 14 位或 16 位)。不过，系统总精度通常受限于噪声、热梯度及 PCB 布局等其他因素，仅提高分辨率并不会显著改善整体精度。

ADC 输入端同时呈现电容负载和动态采样电流。这些效应可能在传感器输出端引入电压扰动，包括瞬态压降和高频噪声。如第 7.3.2.2 节所述，电容负载还会影响输出稳定性，在系统设计中必须予以考虑。

为了减轻这些影响，建议在 ADC 输入端采用由 R_{FILTER} 和 C_{FILTER} 构成的 RC 滤波器。该滤波器可衰减高频噪声，将传感器输出与 ADC 采样瞬态干扰隔离，并提高转换期间的信号稳定性。

图 8-2 展示了将 ISOTMP35R-Q1 输出连接到 ADC 的推荐连接。在该配置中， C_{LOAD} 在器件输出端提供本地高频滤波，而 ADC 输入端的 RC 网络进一步降低噪声和瞬态影响。

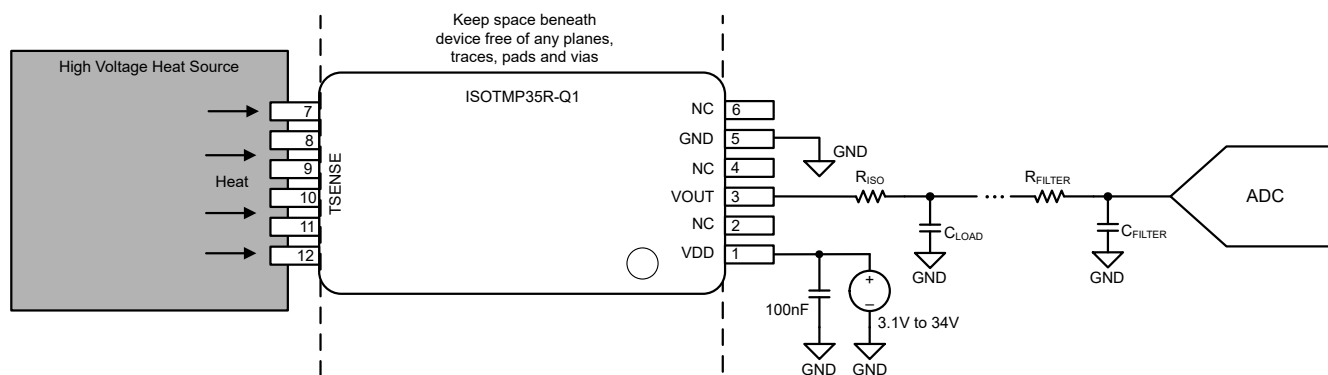


图 8-2. 将 ISOTMP35R-Q1 输出连接到 ADC

在走线较长或电磁干扰较强的系统中，通常需要额外增加滤波或缓冲来保持测量精度。

8.1.4 电源相关建议

ISOTMP35R-Q1 工作电源电压范围为 3.1V 至 34V，可灵活集成至各类系统架构中。

建议使用稳定且低噪声的电源，以实现高测量精度。必须尽可能靠近 V_{DD} 引脚放置一个 0.1 μ F 旁路电容器。该电容器可为高频瞬态提供低阻抗路径，是器件正常工作的必要条件。

在许多应用中，电源电压来自开关稳压器或受到高频噪声的影响。在这些情况下，需要增加额外的滤波以降低耦合至器件内部的噪声。

可在 V_{DD} 引脚上串联一个铁氧体磁珠，并与本地旁路电容器相结合，以衰减传导高频噪声。选择直流电阻较低 ($DCR < 1\ \Omega$) 的铁氧体磁珠，以避免引入影响器件性能的压降。

电源滤波的有效性取决于系统噪声环境及 PCB 布局。节 8.1.5.1 中介绍了更多滤波技术。

8.1.5 EMI 抑制与滤波

ISOTMP35R-Q1 常用于包含快速开关器件（如 MOSFET、IGBT 或开关稳压器）的高压系统。此类系统会产生高 dv/dt 瞬变和电磁干扰 (EMI)，这些干扰可通过 PCB 走线、寄生电容或隔离栅耦合至传感器输出。

若未适当抑制，此类耦合噪声可能在输出端 (V_{OUT}) 引入电压扰动，从而导致测量误差或系统精度下降。

ISOTMP35R-Q1 具有高共模瞬态抗扰度 (CMTI)，可更大限度地减小快速共模电压切换的影响，如 节 7.3.2.3 所述。然而，仍需采取系统级滤波和适当的布局实践，以进一步降低噪声耦合并维持可靠运行。

通过本地输出滤波、信号路径滤波、电源滤波以及审慎的布局实践相结合，可实现有效的 EMI 抑制。

8.1.5.1 滤波技术

EMI 抑制从原理图层面开始。可对 V_{OUT} 信号路径应用低通滤波，以便在信号到达 ADC 之前衰减高频噪声。

一种典型的实现方案为：在 V_{OUT} 引脚上放置一个电容器 (C_{LOAD})，靠近 ADC 输入端放置一个 RC 滤波器。位于器件输出端的电容器提供本地高频滤波并降低输出噪声。由于该电容器直接作为输出级的负载， C_{LOAD} 值必须依据 节 7.3.2.2 所述的电容负载驱动能力进行选择。

使用一个串联电阻器 (R_{ISO}) 将传感器输出与下游电容隔离开并提高稳定性。当 R_{ISO} 大于或等于 300 Ω 时，输出在整个电容负载范围内可保持至少 45° 的相位裕度，从而为下游滤波提供更大灵活性。

ADC 输入端的 RC 网络可衰减高频噪声，并将传感器输出与 ADC 采样瞬态隔离开。在布线距离较长或噪声水平较高的应用中，可采用额外的 RC 滤波级。

可选择将铁氧体磁珠插入信号路径或电源路径，以抑制高频干扰。使用铁氧体磁珠时必须在系统级别进行评估，因为如果选择不当，其频率相关阻抗可能引入信号失真。

图 8-3 展示了一种适用于高 EMI 环境或信号布线较长的系统的多级滤波配置示例。在大多数应用中，在 ADC 输入端设置单级 RC 滤波并配合适当选择的 R_{ISO} 就足够了。

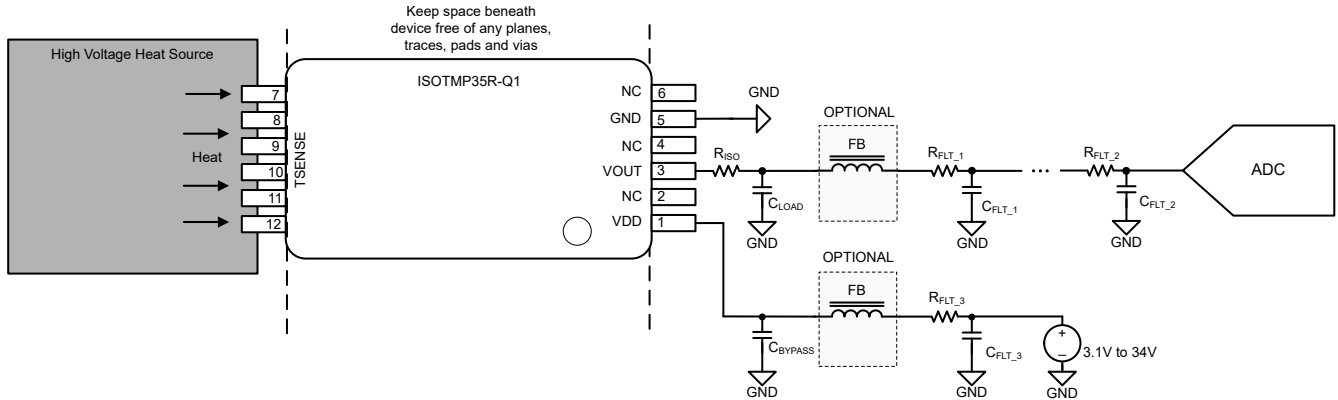


图 8-3. 适用于高 EMI 环境的多级滤波配置示例

在大多数应用中，对 V_{DD} 和 V_{OUT} 进行滤波足以实现良好的噪声性能。除非存在明显的接地噪声，否则通常无需对接地路径进行滤波，因为接地路径滤波可能引入直流偏移，进而影响测量精度。

8.1.5.2 EMI 滤波设计指南

图 8-3 所示的滤波配置展示了一种可根据系统噪声状况及布线要求进行调整的可扩展方案。至少需要在 V_{OUT} 引脚上放置一个电容器 (C_{LOAD})，以提供本地高频滤波。由于该电容器直接作为输出级的负载，其容值必须依据节 7.3.2.2 所述的电容负载驱动能力进行选择。对于未使用串联隔离电阻器的应用， V_{OUT} 处所见的总有效电容不得超过 2.2nF。

对于存在下游滤波、长走线或未知电容负载的应用，建议使用图 8-3 中所示的串联隔离电阻器 (R_{ISO})。当 R_{ISO} 大于或等于 300 Ω 时，输出在整个电容负载范围内可保持至少 45° 的相位裕度，从而为下游滤波提供更大灵活性。

建议在 ADC 输入端附近放置一个由 R_{FLT_2} 和 C_{FLT_2} 组成的 RC 滤波器，以衰减高频噪声并将传感器输出与 ADC 采样瞬态隔离开。对于大多数应用，此级即为主要的信号调节滤波器。

在布线距离较长或电磁干扰较强的系统中，可使用额外的滤波级（如 C_{FLT_1} 和 R_{FLT_1} ）进一步衰减噪声。这些滤波级仅根据系统级评估按需选用。可选择将铁氧体磁珠插入信号路径或电源路径，以抑制高频干扰。仅在组装可选的铁氧体磁珠时才需要 R_{FLT_3} ，用于在磁珠与下游电容之间提供阻尼，以抑制谐振并维持稳定的滤波特性。

在电源路径上，必须始终在 V_{DD} 引脚附近放置一个本地旁路电容器 (C_{BYPASS})。可采用铁氧体磁珠与电容器 (C_{FLT_3}) 构成的附加滤波级来降低电源线上的传导噪声。只有直接连接到 V_{OUT} 的电容会影响输出级的有效负载。位于 R_{ISO} 下游的电容不会影响输出稳定性。

图 8-3 中使用的元件值可作为推荐的起始值；但是，最终值需根据系统噪声频谱、ADC 特性及 PCB 布局等系统级条件确定，并须在系统设计阶段进行验证。

8.1.6 绝缘寿命

ISOTMP35R-Q1 的绝缘寿命采用业界通用的时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 方法进行表征。

在此测试中，将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起，形成一种两端子结构。在隔离栅两端施加高电压，同时监测介电击穿随时间变化的情况。测试在多个电压电平及温度下进行，施加 60Hz 交流电压。利用测得的数据对隔离栅的长期特性进行建模，并据此确定允许的工作条件。

图 8-4 展示了 TDDB 寿命预测情况。红线代表拟合的 TDDB 模型，对应低于百万分之一的失效率 (1 DPPM)。阴影区域表示器件的推荐工作区域。

在 1,060V_{RMS} 的工作隔离电压及 150°C 的结温下，预计绝缘寿命超过 15 年。在规定的隔离额定值范围内运行可保持预期的绝缘寿命。

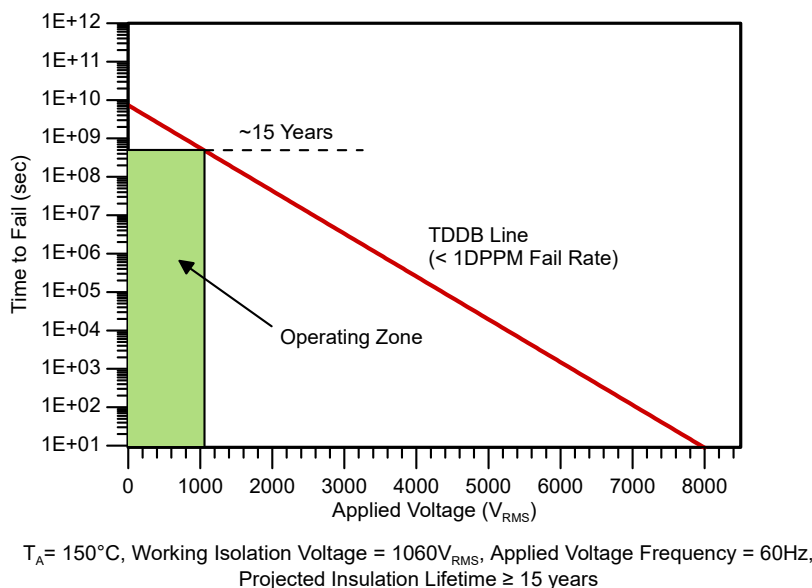


图 8-4. 隔离寿命预测

8.2 布局

8.2.1 布局指南

合理的 PCB 布局对于充分发挥 ISOTMP35R-Q1 器件的性能至关重要。应将该器件尽可能靠近热源放置，以更大限度减少热梯度并提高测量精度。TSENSE 引脚的位置必须确保与发热元件直接进行热耦合。

如果热源位于 PCB 的另一侧，则应在 TSENSE 引脚正下方布置一小块铜区域，并通过导热过孔将该铜区域连接至热源。该铜区域用作局部热界面，而过孔则在热源与传感器之间提供低热阻路径。在附近使用多个过孔以增强传热效果。

所有滤波元件（包括旁路电容器和 RC 滤波器）均应尽可能靠近器件引脚放置，以更大限度减少寄生电感并降低对电磁干扰 (EMI) 的敏感性。

必须谨慎管理信号布线。 V_{OUT} 走线应远离高 dv/dt 开关节点和 high 电流路径，并尽可能缩短走线长度以降低噪声拾取量。在需要较长的布线距离时，建议增加额外的滤波或缓冲以保持信号完整性（有关更多详细信息，请参阅节 8.1.2）。

需要低阻抗接地连接。连续的接地平面可提供稳定的基准并降低噪声耦合。

隔离栅需要至少 8mm 的爬电距离和电气间隙。建议至少使用 2 层 PCB 堆叠。在 4 层 PCB 设计中，信号布线可置于顶层或底层。隔离栅下方的区域必须保持没有导电元素（包括覆铜平面、走线、焊盘和过孔），以确保器件的隔离完整性。

有关器件下方所需禁止区域的示例，请参阅图 8-5。

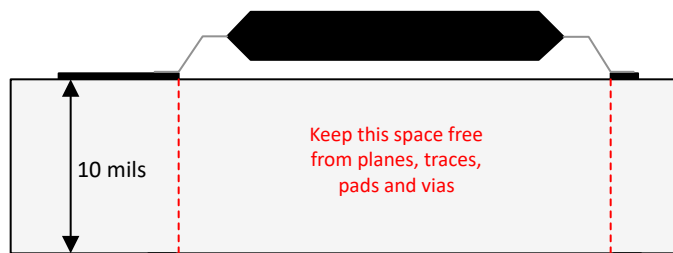


图 8-5. 隔离栅禁止区域（横截面视图）

8.2.2 布局示例

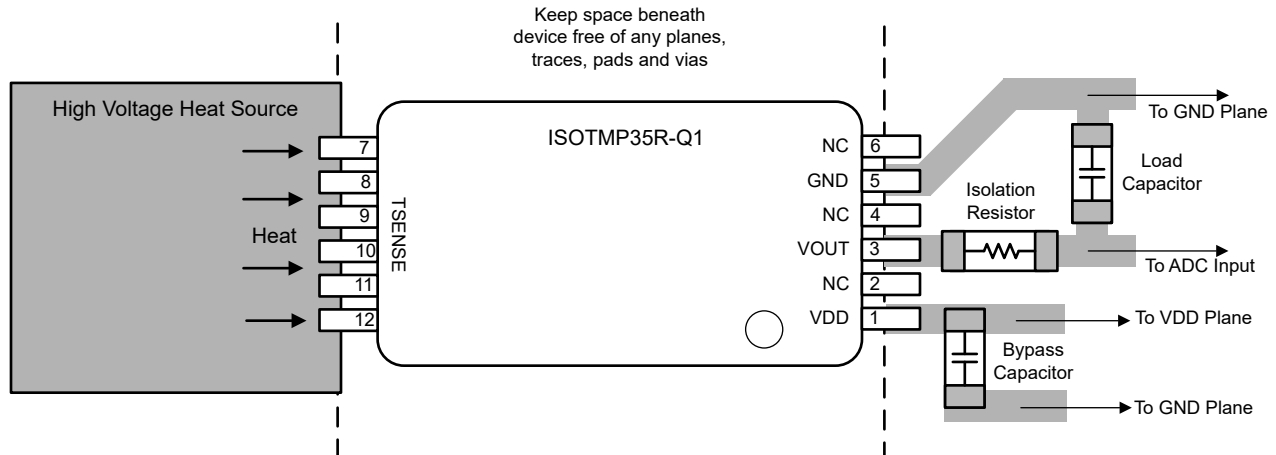


图 8-6. ISOTMP35R-Q1 布局示例

9 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

如要查看相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，[ISOTMP35R 评估模块用户指南](#)
- 德州仪器 (TI)，[改善高压应用中的热响应时间和精度](#)
- 德州仪器 (TI)，[采用高增益仪表放大器驱动 ADC 的电路](#)
- 德州仪器 (TI)，[在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR ADC \(低功耗、低采样速度 DAQ\)](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from MAY 21, 2026 to JULY 6, 2026 (from Revision A (May 2026) to Revision B (July 2026))	Page
• 更新了典型特性中的精度与电源电压和负载电流间的关系图.....	10

Changes from SEPTEMBER 1, 2025 to MAY 21, 2026 (from Revision * (September 2025) to Revision A (May 2026))

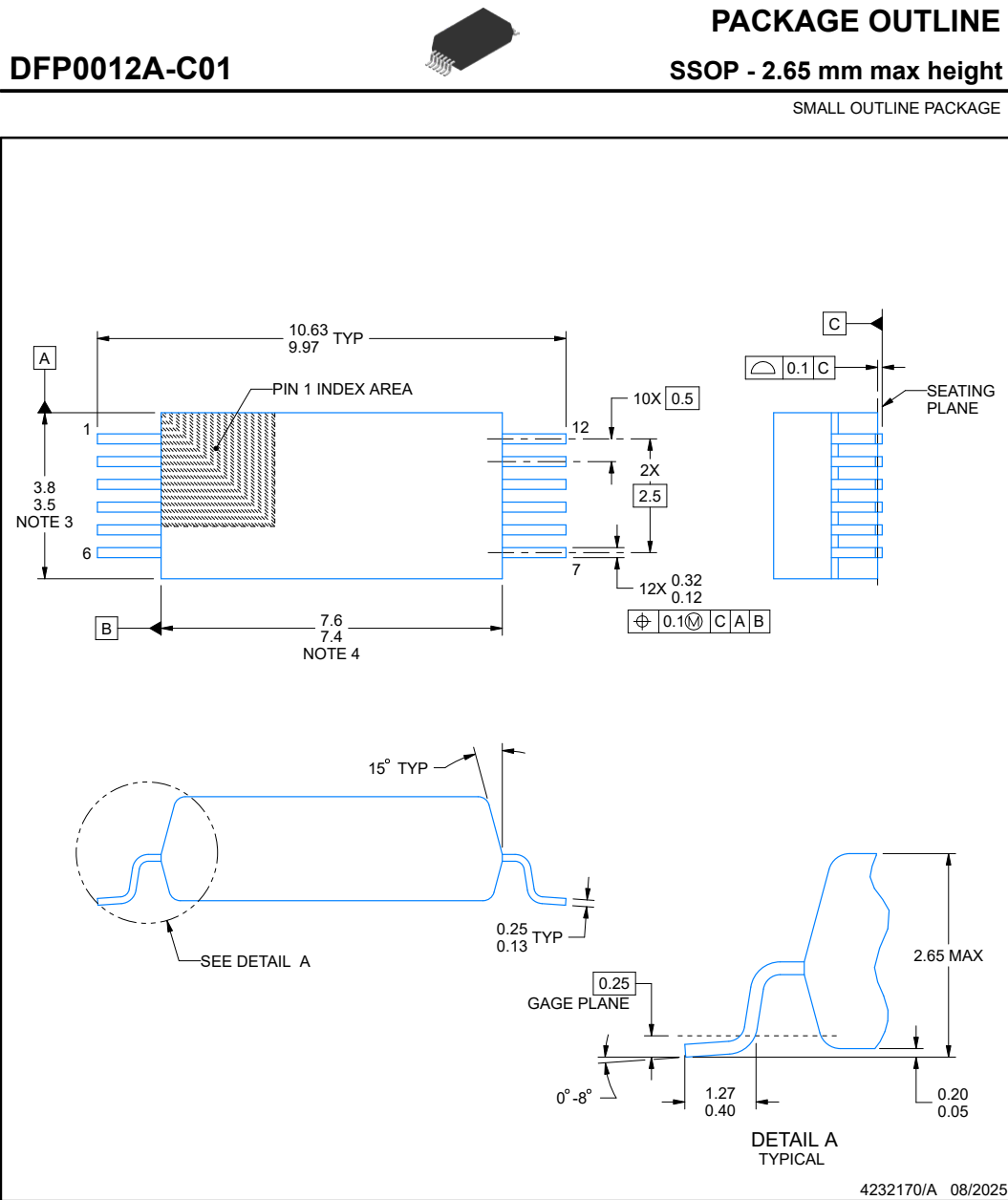
Page

-
- 将该数据表状态更改为“量产数据” **1**
-

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

11.1 机械数据

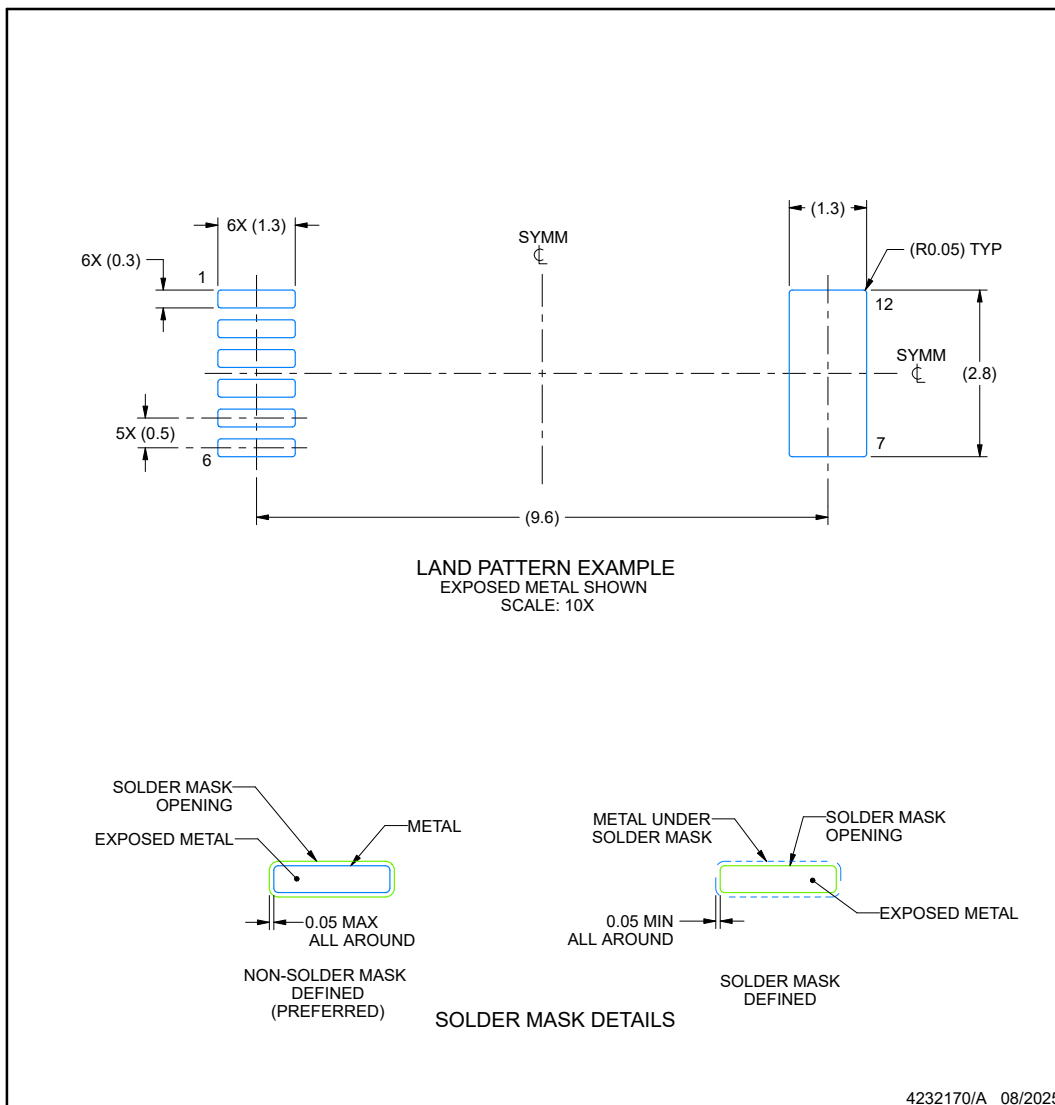


EXAMPLE BOARD LAYOUT

DFP0012A-C01

SSOP - 2.65 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

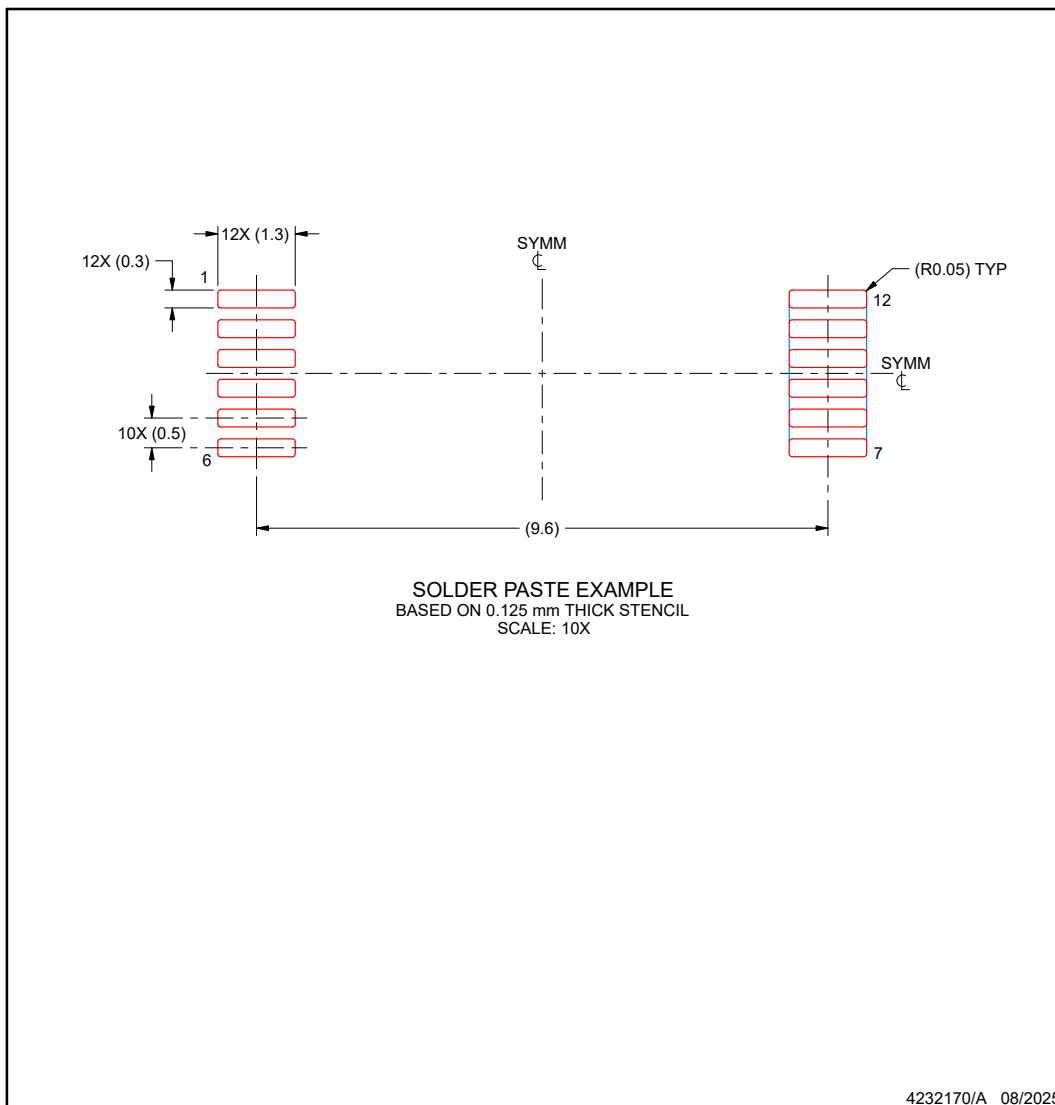


NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN**DFP0012A-C01****SSOP - 2.65 mm max height**

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

11.2 封装选项附录

封装信息

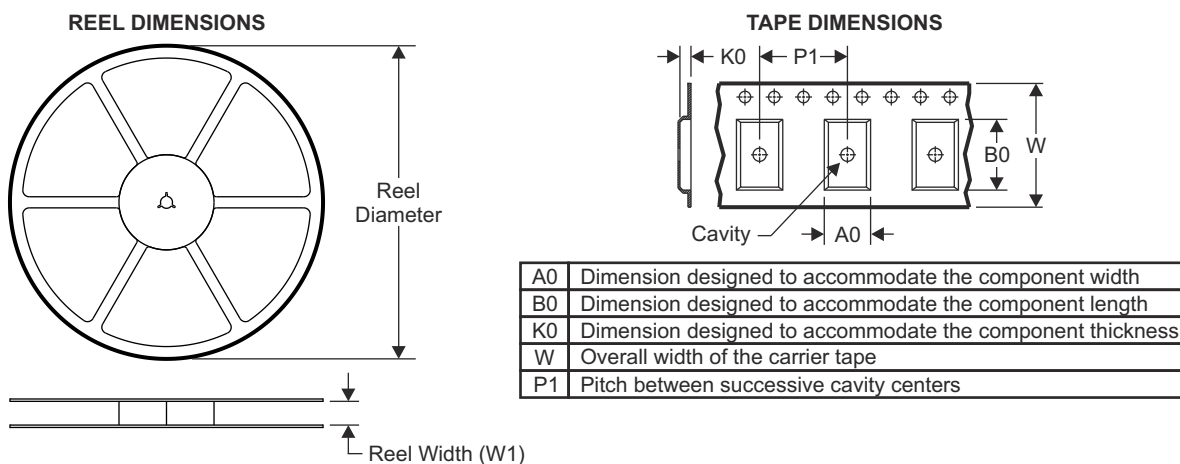
可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁶⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ^{(4) (5)}
ISOTMP35RED FPRQ1	运行	SSOP	DFP	12	2,000	无铅 (RoHS)	NiPdAu	Level-1-260C- UNLIM	-40 至 150	3SZS

- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD：器件未发布，尚未量产，未向大众市场供货，也未在网络上供应，未提供样片。
预发布：器件已发布，但未量产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情，请访问 www.ti.com.cn/productcontent。
待定：无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。
绿色环保 (RoHS，无镉/溴)：TI 定义的“绿色环保”表示无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 系阻燃剂 (均质材料中 Br 或 Sb 的质量不超过总质量的 0.1%)。
- (3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
- (5) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
- (6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。

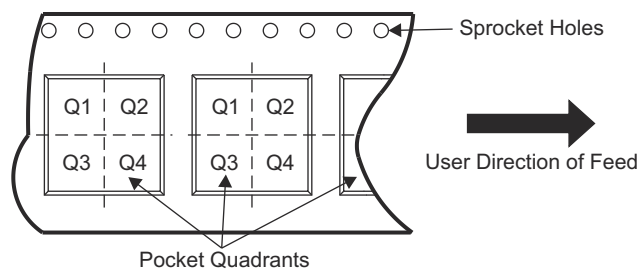
重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

11.3 卷带包装信息

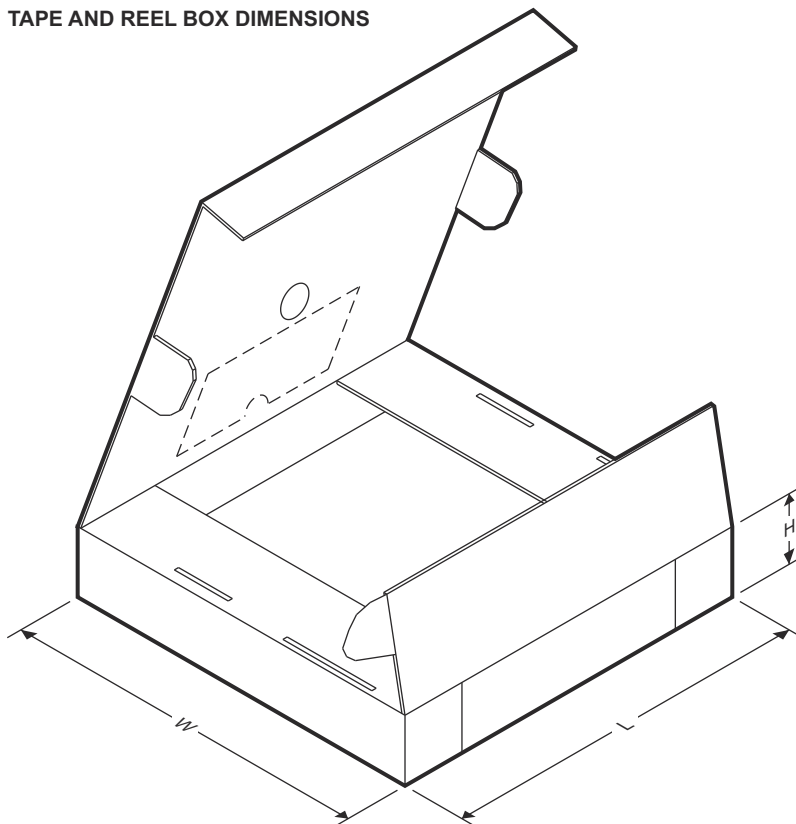


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
ISOTMP35REDFPRQ1	SSOP	DFP	12	2,000	330.0	12.4	10.9	3.98	2.7	12.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
ISOTMP35REDFPRQ1	SSOP	DFP	12	2,000	353.0	353.0	32.0

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月